(19)日本國特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-171230 (P2000-171230A)

(43)公開日 平成12年6月23日(2000.6.23)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

G01B 15/04

G 0 1 N 21/956

G01B 15/04

G 0 1 N 21/956

Α

審査請求 未請求 請求項の数22 OL (全 29 頁)

(21)出願番号

特願平11-274696

(22)出顧日

平成11年9月28日(1999.9.28)

(31)優先権主張番号 特願平10-276043

(32)優先日

平成10年9月29日(1998.9.29)

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 塚田 弘志

神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 株

式会社東芝生産技術センター内

(72)発明者 石井 勝博

栃木県大田原市下石上1385番の1 株式会

社東芝那須工場内

(74)代理人 100058479

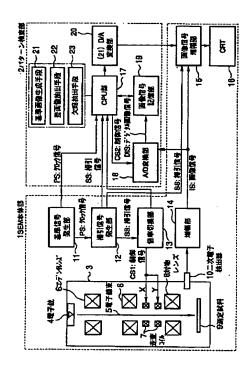
弁理士 鈴江 武彦 (外6名)

(54) 【発明の名称】 微小パターン形状検査方法及びその装置

(57)【要約】

【課題】本発明は、精度高く微小パターンの検査を行

【解決手段】複数の良品画像データに基づいて濃度差や 形状差のばらつきに応じた基準画像データを生成する基 準画像生成手段21と、この基準画像生成手段21で生 成された基準画像データと被検査画像データとの画像間 演算を行ってその差画像データを抽出する差画像抽出手 段22と、この差画像抽出手段22で抽出された差画像 データと予め定められたしきい値とを比較して濃度の欠 陥部分や形状の欠陥部分を抽出する欠陥抽出手段23と を備えた。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の良品画像データに基づいて濃度差 や形状差のばらつきに応じた基準画像データを生成する 基準画像生成工程と、

この基準画像生成工程で生成された前記基準画像データ と被検査画像データとの画像間演算を行ってその差画像 データを抽出する差画像抽出工程と、

この差画像抽出工程で抽出された前記差画像データと予 め定められたしきい値とを比較して濃度の欠陥部分や形 状の欠陥部分を抽出する欠陥抽出工程と、を有すること 10 を特徴とする微小パターン形状検査方法。

【請求項2】 測定試料に電子線束を照射したときに前 記測定試料から放出される二次電子を検出して得られる 画像データを被検査画像データとして前記測定試料に形 成された微小パターンの検査を行う微小パターン形状検 査装置において、

複数の良品画像データに基づいて濃度差や形状差のばら つきに応じた基準画像データを生成する基準画像生成手 段と、

この基準画像生成手段で生成された前記基準画像データ 20 と前記被検査画像データとの画像間演算を行ってその差 画像データを抽出する差画像抽出手段と、

この差画像抽出手段で抽出された前記差画像データと予 め定められたしきい値とを比較して濃度の欠陥部分や形 状の欠陥部分を抽出する欠陥抽出手段と、を具備したと とを特徴とする微小パターン形状検査装置。

【請求項3】 前記基準画像生成手段は、複数の前記良 品画像データの各画像値のうち座標位置ごとに各最大値 から形成される上限濃淡画像データ、

複数の前記良品画像データの各画像値のうち座標位置と 30 とに各最小値から形成される下限濃淡画像データ、

前記良品画像データを微分処理した画像データの各画像 値のうち座標位置ごとに各最大値から形成される上限微 分画像データ、

前記良品画像データを微分処理した画像データの各画像 値のうち座標位置ととに各最小値から形成される下限微 分画像データ、

前記上限濃淡画像データと前記下限濃淡画像データとを 平均処理した平均濃淡画像データ、

前記上限微分画像データと前記下限微分画像データとを 40 平均処理した平均微分画像データ、

を生成する機能を有することを特徴とする請求項2記載 の微小パターン形状検査装置。

【請求項4】 前記差画像抽出手段は、前記上限濃淡画 像データと前記被検査画像データとの差、及び前記下限 濃淡画像データと前記被検査画像データとの差に基づい て濃淡差画像データを得、かつ前記上限微分画像データ と前記被検査画像データとの差、及び前記下限微分画像 データと前記被検査画像データとの差に基づいて微分差 画像データを得る機能を有することを特徴とする請求項 50 2記載の微小パターン形状検査装置。

【請求項5】 前記欠陥抽出手段は、前記濃淡差画像デ ータと予め定められたしきい値とを比較して濃度の欠陥 部分を抽出し、かつ前記微分差画像データと予め定めら れたしきい値とを比較して形状の欠陥部分を抽出する機 能を有することを特徴とする請求項2記載の微小パター ン形状検査装置。

【請求項6】 凹凸状で湾曲状に形成された微小バター ンを撮影して得られた画像データに基づいて前記微小バ ターンの検査を行う微小パターン形状検査方法におい て、

前記微小バターンの形状に応じた湾曲状の検査領域を前 記画像データに対して設定する検査領域設定工程と、

この検査領域設定工程で設定された前記検査領域の湾曲 方向を横切る部分の輝度分布に基づいて濃度ビーク点列 を求める濃度ピーク点列工程と、

この濃度ビーク点列工程で求められた前記濃度ビーク点 列に対して略垂直方向でかつ前記濃度ピーク点を含む範 囲での濃度データを前記濃度ピーク点列の複数箇所で取 得する取得濃度データ工程と、

この取得濃度データ工程で取得された前記各濃度データ に対してそれぞれ所定の各値を演算して求め、これら値 と予め設定された良否判定基準とを比較して前記微小バ ターンの良否を判定する欠陥判定工程と、

を有することを特徴とする微小パターン形状検査方法。

【請求項7】 測定試料に電子線束を照射したときに前 記測定試料から放出される二次電子を検出して得られる 画像データを被検査画像データとして前記測定試料に形 成された凹凸状で湾曲状の微小パターンの検査を行う微 小パターン形状検査装置において、

前記微小バターンの形状に応じた湾曲状の検査領域を前 記画像データに対して設定する検査領域設定手段と、

この検査領域設定手段で設定された前記検査領域の湾曲 方向を横切る部分の輝度分布に基づいて濃度ビーク点列 を求める濃度ピーク点列手段と、

この濃度ビーク点列手段で求められた前記濃度ビーク点 列に対して略垂直方向でかつ前記濃度ピーク点を含む節 囲での濃度データを前記濃度ピーク点列の複数箇所で取 得する取得濃度データ手段と、

との取得濃度データ手段で取得された前記各濃度データ に対してそれぞれ所定の各値を演算して求め、これら値 と予め設定された良否判定基準とを比較して前記微小バ ターンの良否を判定する欠陥判定手段と、を具備したと とを特徴とする微小パターン形状検査装置。

【請求項8】 前記検査領域設定手段は、楕円状の前記 微小パターンに対して前記微小パターンの縁の外側及び 内側にそれぞれ配置される各楕円により形成される前記 検査領域を設定する機能を有することを特徴とする請求 項7記載の微小パターン形状検査装置。

【請求項9】 前記濃度ピーク点列手段は、前記検査領

域の各楕円を横切る各直線を所定角度毎に設定し、これ ら直線上の各輝度分布の各濃度ピーク位置を求めて濃度 ピーク点列を取得する機能を有することを特徴とする請 求項7記載の微小パターン形状検査装置。

【請求項10】 前記取得濃度データ手段は、前記濃度 データを取得する前記濃度ピーク点を含む範囲を前記微 小パターンの凹凸状のダレ量、前記微小パターンの歪み 量、そのサイズ変動に応じて設定する機能を有することを特徴とする請求項7記載の微小パターン形状検査装置

【請求項11】 前記欠陥判定手段は、前記各濃度データに対してそれぞれ所定の方向に輝度を加算し、との濃度加算値の最大、最小、平均、分散を演算して求め、とれら最大、最小、平均、分散値と予め設定された良否判定基準とを比較して前記微小バターンの良否を判定する機能を有するととを特徴とする請求項7記載の微小バターン形状検査装置。

【請求項12】 凹凸状で湾曲状に形成された微小バターンを撮影して得られた画像データに基づいて前記微小バターンの検査を行う微小バターン形状検査方法におい 20 て、

前記微小バターンの形状に応じた検査領域内の輝度分布 に基づいて求められる濃度ピーク点列に対してフィルタ 処理を施す第1の形状処理工程と、

基準とする微小パターンの形状に応じた検査領域内の輝度分布に基づいて求められる濃度ビーク点列に対してフィルタ処理を施す第2の形状処理工程と、

これら第1と第2の形状処理工程によりそれぞれフィルタ処理された濃度ピーク点列と基準とする濃度ピーク点列とを比較して前記微小パターンの評価を行う評価工程 30と、を有することを特徴とする微小パターン形状検査方法。

【請求項13】 前記第1と第2の形状処理工程は、前記微小パターン又は基準とする微小パターンの形状に応じた湾曲状の検査領域を前記画像データに対して設定する検査領域設定工程と、

この検査領域設定工程で設定された前記検査領域の湾曲 方向を横切る部分の輝度分布に基づいて前記濃度ピーク 点列を求める濃度ピーク点列工程と、

この濃度ビーク点列工程で求められた前記濃度ビーク点 40 列に対してフィルタ処理を施すフィルタ処理工程と、を有することを特徴とする請求項12記載の微小パターン形状検査方法。

【請求項14】 前記フィルタ処理工程は、前記濃度ピーク点列をフーリエ級数展開し、所定の次数までのフーリエ係数を用いて形状復元することを特徴とする請求項13記載の微小バターン形状検査方法。

【請求項15】 測定試料に電子線束を照射したときに 前記測定試料から放出される二次電子を検出して得られ る画像データを被検査画像データとして前記測定試料に 50

形成された凹凸状で湾曲状の微小バターンの検査を行う 微小バターン形状検査装置において

前記微小パターンの形状に応じた検査領域内の輝度分布 に基づいて求められる濃度ビーク点列に対してフィルタ 処理を施す第1の形状処理手段と、

基準とする微小パターンの形状に応じた検査領域内の輝度分布に基づいて求められる濃度ピーク点列に対してフィルタ処理を施す第2の形状処理手段と、

これら第1と第2の形状処理手段によりそれぞれフィルタ処理された濃度ビーク点列と基準とする濃度ビーク点列とを比較して前記微小パターンの評価を行う評価手段と、を具備したことを特徴とする微小パターン形状検査装置。

【請求項16】 前記第1と第2の形状処理手段は、前 記微小パターン又は基準とする微小パターンの形状に応 じた湾曲状の検査領域を前記画像データに対して設定す る検査領域設定手段と、

この検査領域設定手段で設定された前記検査領域の湾曲 方向を横切る部分の輝度分布に基づいて前記濃度ピーク 点列を求める濃度ピーク点列手段と、

この濃度ピーク点列手段で求められた前記濃度ピーク点列に対してフィルタ処理を施すフィルタ処理手段と、を 具備したことを特徴とする請求項15記載の微小パターン形状検査装置。

【請求項17】 前記フィルタ処理手段は、前記濃度ピーク点列をフーリエ級数展開し、所定の次数までのフーリエ係数を用いて形状復元する機能を有することを特徴とする請求項16記載の微小バターン形状検査装置。

【請求項18】 前記評価手段は、前記フィルタ処理された前記濃度ピーク点列と基準とする前記濃度ピーク点列となりそれぞれ形成される各パターンサイズの少なくとも横幅が同じになるように調整する機能を有することを特徴とする請求項15記載の微小パターン形状検査装置。

【請求項19】 前記評価手段は、前記フィルタ処理された前記濃度ピーク点列と基準とする前記濃度ピーク点列と基準とする前記濃度ピーク点列とを重ね合わせ、これら濃度ピーク点列と基準とする濃度ピーク点列との各パターン間のずれ量の総和を前記微小パターンの形状歪み評価値とする機能を有することを特徴とする請求項15記載の微小パターン形状検査装置。

【請求項20】 微小バターンを撮影して得られた画像信号における前記微小バターンの輪郭部分に対応する両側の各縁部を求め、これら縁部の間隔から前記微小バターンの線幅を求めることを特徴とする微小バターン形状検査方法。

【請求項21】 測定試料に電子線束を照射したときに前記測定試料から放出される二次電子を検出して得られる画像信号に基づいて前記微小パターンの検査を行う微小パターン形状検査装置において、

前記微小バターンを撮影して得られた前記画像信号に対して複数の平滑化サイズで波形の平滑化を行う平滑化手段と、

この平滑化手段により得られる平滑化サイズの異なる各平滑化波形データの差分波形データを求める差分波形手段と、

この差分波形手段により求められた差分波形データとこの差分波形データを求めるのに前記差分波形手段で用いた前記各平滑化波形データとに基づいて前記微小バターンの輪郭部分に対応する両側の各縁部を求め、これら縁 10 部の間隔を前記微小バターンの線幅として求める幅計測手段と、を具備したことを特徴とする微小バターン形状検査装置。

【請求項22】 前記電子線束の径による畳み込みによるボケ量以上の前記平滑化サイズで求めた前記微小パターンの線幅の系列からその回帰曲線を求め、この回帰曲線の前記平滑化サイズがゼロの位置の値から前記電子線束の径がゼロのときの前記微小パターンの線幅を求める機能を有することを特徴とする請求項21記載の微小パターン形状検査装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば半導体ウェ ハ上に形成された微小バターンの欠陥やそのテーバ部の 状態、さらには寸法を測定する微小バターン形状検査方 法及びその装置に関する。

[0002]

【従来の技術】このような半導体ウエハ上に形成された 微小パターンの検査には、例えば走査型電子顕微鏡(S EM: Scanning Elctron Microscope)が用いられてい 30 る。このSEMは、測定試料に電子線束(電子ビーム) を照射し、このとき測定試料から放出される二次電子を 検出して画像データを得るもので、この画像データを画 像処理することによって測定試料に形成された微小パタ ーンの欠陥検査やこの微小パターンのテーパ部の状態、 さらにはその寸法測定を行っている。

【0003】このうち微小バターンの欠陥は、この微小バターンの画像をモニタ上に拡大表示し、このモニタ上に表示された画像を検査員が目視により確認することによって検査している。この微小バターンの欠陥検査で微 40小バターンの形状に歪みがなく真円のものに対しては、真円の中心からR - 0変換し、この変換した画像を処理することで微小バターンの傷、汚れを検査している。

【0004】又、微小バターンの形状歪みは、その微小 パターンの縦横比、周囲長、面積などを計測し、規格値 と比較することで検査を行っている。

【0005】又、微小バターンの寸法測定は、微小バターンの画像をモニタ上に拡大表示し、このモニタ上に表示された画像に対して検査員がカーソルを当ててそのカーソル間の距離と倍率とから測定を行っている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、検査員がモニタ上に拡大表示された微小バターンの画像を目視して微小バターンの欠陥やそのテーバ部の状態を検査する方法では、検査員によって評価基準にばらつきが生じ、定量的な検査が不可能である。そして、半導体ウェハの微小バターンのような多様な形状で変形や歪みの多い測定試料については、精度高く検査・評価を行うことができない。

【0007】又、微小パターンの形状歪みは、微小パターンの縦横比、周囲長、面積などを計測し、規格値と比較することで検査を行っているが、これら縦横比、周囲長、面積などでは、形状歪みを精度高く表現することができず、大まかな検査しかできない。

【0008】又、検査員が微小バターンの画像が表示されているモニタ上にカーソルを当てて寸法測定を行う方法では、カーソルの当方によって測定結果にばらつきが生じ、高精度の測定が不可能である。

【0009】そこで本発明は、精度高く微小バターンの 20 検査ができる微小バターン形状検査方法及びその装置を 提供することを目的とする。

【0010】又、本発明は、微小パターンの形状検査を 自動的に高精度に行うことができる微小パターン形状検 査方法及びその装置を提供することを目的とする。

【0011】又、本発明は、多様な形状で変形や歪みのある微小パターンのテーパ部の形状検査を自動的に高精度に行うことができる微小パターン形状検査方法及びその装置を提供することを目的とする。

【0012】又、本発明は、微小バターンの形状歪みを 自動的に高精度に行うことができる微小バターン形状検 査方法及びその装置を提供することを目的とする。

【0013】又、本発明は、微小パターンの寸法測定を自動的に高精度に行うととができる微小パターン形状検査方法及びその装置を提供するととを目的とする。 【0014】

【課題を解決するための手段】請求項1によれば、複数の良品画像データに基づいて濃度差や形状差のばらつきに応じた基準画像データを生成する基準画像生成工程と、この基準画像生成工程で生成された基準画像データと被検査画像データとの画像間演算を行ってその差画像データを抽出する差画像抽出工程と、この差画像抽出工程で抽出された差画像データと予め定められたしきい値とを比較して濃度の欠陥部分や形状の欠陥部分を抽出する欠陥抽出工程と、を有する微小パターン形状検査方法である。

【0015】請求項2によれば、測定試料に電子線束を 照射したときに測定試料から放出される二次電子を検出 して得られる画像データを被検査画像データとして測定 試料に形成された微小パターンの検査を行う微小パター ン形状検査装置において、複数の良品画像データに基づ

いて濃度差や形状差のばらつきに応じた基準画像データを生成する基準画像生成手段と、この基準画像生成手段で生成された基準画像データと被検査画像データとの画像間演算を行ってその差画像データを抽出する差画像抽出手段と、この差画像抽出手段で抽出された差画像データと予め定められたしきい値とを比較して濃度の欠陥部分や形状の欠陥部分を抽出する欠陥抽出手段と、を備えた微小バターン形状検査装置である。

【0016】請求項3によれば、請求項2記載の微小パターン形状検査装置において、基準画像生成手段は、複 10 数の良品画像データの各画像値のうち座標位置ごとに各最大値から形成される上限濃淡画像データ、複数の良品画像データの各画像値のうち座標位置ごとに各最小値から形成される下限濃淡画像データ、良品画像データを微分処理した画像データの各画像値のうち座標位置ごとに各最大値から形成される上限微分画像データ、良品画像データを微分処理した画像データの各画像値のうち座標位置ごとに各最小値から形成される下限微分画像データ、上限濃淡画像データとを平均処理した平均濃淡画像データとを平均処理した平均濃淡画像データとを平均処理した平均微分画像データとを平均処理した平均微分画像データ、を生成する機能を有する。

【0017】請求項4によれば、請求項2記載の微小バターン形状検査装置において、差画像抽出手段は、上限 濃淡画像データと被検査画像データとの差及び下限濃淡 画像データと被検査画像データとの差に基づいて濃淡差 画像データを得、かつ上限微分画像データと被検査画像データとの差及び下限微分画像データと被検査画像データとの差に基づいて微分差画像データを得る機能を有する。

【0018】請求項5によれば、請求項2記載の微小バターン形状検査装置において、欠陥抽出手段は、濃淡差画像データと予め定められたしきい値とを比較して濃度の欠陥部分を抽出し、かつ微分差画像データと予め定められたしきい値とを比較して形状の欠陥部分を抽出する機能を有する。

【0019】請求項6によれば、凹凸状で湾曲状に形成された微小パターンを撮影して得られた画像データに基づいて微小パターンの検査を行う微小パターン形状検査方法において、微小パターンの形状に応じた湾曲状の検 40 査領域を画像データに対して設定する検査領域設定工程と、この検査領域設定工程で設定された検査領域の湾曲方向を横切る部分の輝度分布に基づいて濃度ビーク点列を求める濃度ビーク点列工程と、この濃度ビーク点列工程で求められた濃度ビーク点列に対して略垂直方向でかつ濃度ビーク点を含む範囲での濃度データを濃度ビーク点列の複数箇所で取得する取得濃度データ工程と、この取得濃度データ工程で取得された各濃度データに対してそれぞれ所定の各値を演算して求め、これら値と予め設定された良否判定基準とを比較して微小パターンの良否 50

を判定する欠陥判定工程と、を有する微小パターン形状 検査方法である。

【0020】請求項7によれば、測定試料に電子線束を 照射したときに測定試料から放出される二次電子を検出 して得られる画像データを被検査画像データとして測定 試料に形成された凹凸状で湾曲状の微小パターンの検査 を行う微小パターン形状検査装置において、微小パター ンの形状に応じた湾曲状の検査領域を画像データに対し て設定する検査領域設定手段と、この検査領域設定手段 で設定された検査領域の湾曲方向を横切る部分の輝度分 布に基づいて濃度ピーク点列を求める濃度ピーク点列手 段と、この濃度ピーク点列手段で求められた濃度ピーク 点列に対して略垂直方向でかつ濃度ピーク点を含む範囲 での濃度データを濃度ビーク点列の複数箇所で取得する 取得濃度データ手段と、この取得濃度データ手段で取得 された各濃度データに対してそれぞれ所定の各値を演算 して求め、これら値と予め設定された良否判定基準とを 比較して微小パターンの良否を判定する欠陥判定手段 と、を備えた微小パターン形状検査装置である。

【0021】請求項8によれば、請求項7記載の微小バターン形状検査装置において、検査領域設定手段は、楕円状の微小バターンに対して微小バターンの縁の外側及び内側にそれぞれ配置される各楕円により形成される検査領域を設定する機能を有する。

【0022】請求項9によれば、請求項7記載の微小バターン形状検査装置において、濃度ビーク点列手段は、検査領域の各楕円を横切る各直線を所定角度毎に設定し、これら直線上の各輝度分布の各濃度ビーク位置を求めて濃度ビーク点列を取得する機能を有する。

【0023】請求項10によれば、請求項7記載の微小パターン形状検査装置において、取得濃度データ手段は、濃度データを取得する濃度ピーク点を含む範囲を微小パターンの凹凸状のダレ重、微小パターンの歪み量、そのサイズ変動に応じて設定する機能を有する。

【0024】請求項11によれば、請求項7記載の微小ハターン形状検査装置において、欠陥判定手段は、各濃度データに対してそれぞれ所定の方向に輝度を加算し、この濃度加算値の最大、最小、平均、分散を演算して求め、これら最大、最小、平均、分散値と予め設定された良否判定基準とを比較して微小パターンの良否を判定する機能を有する。

【0025】請求項12によれば、凹凸状で湾曲状に形成された微小パターンを撮影して得られた画像データに基づいて微小パターンの検査を行う微小パターン形状検査方法において、微小パターンの形状に応じた検査領域内の輝度分布に基づいて求められる濃度ピーク点列に対してフィルタ処理を施す第1の形状処理工程と、基準とする微小パターンの形状に応じた検査領域内の輝度分布に基づいて求められる濃度ピーク点列に対してフィルタ処理を施す第2の形状処理工程と、これら第1と第2の

形状処理工程によりそれぞれフィルタ処理された濃度ビ ーク点列と基準とする濃度ビーク点列とを比較して微小 パターンの評価を行う評価工程と、を有する微小パター ン形状検査方法である。

【0026】請求項13によれば、請求項12記載の微 小パターン形状検査方法において、第1と第2の形状処 理工程は、微小パターン又は基準とする微小パターンの 形状に応じた湾曲状の検査領域を前記画像データに対し て設定する検査領域設定工程と、この検査領域設定工程 で設定された検査領域の湾曲方向を横切る部分の輝度分 10 布に基づいて濃度ピーク点列を求める濃度ピーク点列工 程と、この濃度ピーク点列工程で求められた濃度ピーク 点列に対してフィルタ処理を施すフィルタ処理工程とを 有する。

:【0027】請求項14によれば、請求項13記載の微 小パターン形状検査方法において、フィルタ処理は、濃 度ピーク点列をフーリエ級数展開し、所定の次数までの フーリエ係数を用いて形状復元する。

【0028】請求項15によれば、測定試料に電子線束 を照射したときに測定試料から放出される二次電子を検 20 出して得られる画像データを被検査画像データとして測し 定試料に形成された凹凸状で湾曲状の微小パターンの検 査を行う微小パターン形状検査装置において、微小パタ ーンの形状に応じた検査領域内の輝度分布に基づいて求 められる濃度ピーク点列に対してフィルタ処理を施す第 1の形状処理手段と、基準とする微小パターンの形状に 応じた検査領域内の輝度分布に基づいて求められる濃度 ピーク点列に対してフィルタ処理を施す第2の形状処理 手段と、これら第1と第2の形状処理手段によりそれぞ れフィルタ処理された濃度ピーク点列と基準とする濃度 30 ピーク点列とを比較して微小パターンの評価を行う評価 手段と、を備えた微小パターン形状検査装置である。

【0029】請求項16によれば、請求項15記載の微 小パターン形状検査装置において、第1と第2の形状処 理手段は、微小パターン又は基準とする微小パターンの 形状に応じた湾曲状の検査領域を画像データに対して設 定する検査領域設定手段と、この検査領域設定手段で設 定された検査領域の湾曲方向を横切る部分の輝度分布に 基づいて濃度ピーク点列を求める濃度ピーク点列手段 と、この濃度ピーク点列手段で求められた濃度ピーク点 40 列に対してフィルタ処理を施すフィルタ処理手段とを備 えている。

【0030】請求項17によれば、請求項16記載の微 小パターン形状検査装置において、フィルタ処理手段 は、濃度ピーク点列をフーリエ級数展開し、所定の次数 までのフーリエ係数を用いて形状復元する機能を有す

【0031】請求項18によれば、請求項15記載の微 小パターン形状検査装置において、評価手段は、フィル タ処理された濃度ビーク点列と基準とする濃度ビーク点 50 ック信号PSを出力する基準信号発生部11が設けら

列とによりそれぞれ形成される各パターンサイズの少な くとも横幅が同じになるように調整する機能を有する。 【0032】請求項19によれば、請求項15記載の微 小バターン形状検査装置において、評価手段は、フィル タ処理された濃度ピーク点列と基準とする濃度ピーク点 列とを重ね合わせ、これら濃度ピーク点列と基準とする 濃度ピーク点列との各バターン間のずれ量の総和を微小 パターンの形状歪み評価値とする機能を有する。

【0033】請求項20によれば、微小パターンを撮影 して得られた画像信号における微小パターンの輪郭部分 に対応する両側の各縁部を求め、これら縁部の間隔から 微小パターンの線幅を求める微小パターン形状検査方法 である。

【0034】請求項21によれば、測定試料に電子線束 を照射したときに測定試料から放出される二次電子を検 出して得られる画像信号に基づいて微小パターンの検査 を行う微小パターン形状検査装置において、微小パター ンを撮影して得られた画像信号に対して複数の平滑化サ イズで波形の平滑化を行う平滑化手段と、この平滑化手 段により得られる平滑化サイズの異なる各平滑化波形デ ータの差分波形データを求める差分波形手段と、この差 分波形手段により求められた差分波形データとこの差分 波形データを求めるのに差分波形手段で用いた各平滑化 波形データとに基づいて微小パターンの輪郭部分に対応 する両側の各縁部を求め、これら縁部の間隔を微小パタ ーンの線幅として求める幅計測手段と、を備えた微小パ ターン形状検査装置である。

【0035】請求項22によれば、請求項21記載の微 小パターン形状検査装置において、電子線束の径による 畳み込みによるボケ量以上の平滑化サイズで求めた微小 パターンの線幅の系列からその回帰曲線を求め、この回 帰曲線の平滑化サイズがゼロの位置の値から電子線束の 径がゼロのときの微小パターンの線幅を求める機能を有 する。

[0036]

【発明の実施の形態】(1) 以下、本発明の第1の実施の 形態について図面を参照して説明する。

【0037】図1は微小バターン形状検査装置の構成図 である。

【0038】との微小パターン形状検査装置は、SEM -本体部1とパターン検査部2とから構成されている。と のうちSEM本体部1の電子光学鏡筒3には、その上部 に電子銃4が設けられ、この電子銃4から放出される電 子線束5の進行路に沿ってコンデンサレンズ6、走査コ イル7及び対物レンズ8が設けられている。これと共に 電子光学鏡筒3の下部には、測定試料9が設けられ、か つこの測定試料9の斜め上方に二次電子検出器10が設 けられている。

【0039】又、SEM本体部1には、基準となるクロ

れ、との基準信号発生部11から出力されたクロック信号PSが掃引信号発生部12及び上記パターン検査部2 に送られている。

17

【0040】掃引信号発生部12は、基準信号発生部1 1から出力されたクロック信号PSに基づいて電子線束 5をラスタ走査させるための掃引信号SSを発生させる 機能を有している。

【0041】倍率切換部13は、図示しない倍率切換スイッチの設定と掃引信号発生部12で発生した掃引信号SSとの組み合わせで走査コイル7に対して制御信号C 10S1を送出し、との走査コイル7によって電子線束5の走査方向及び幅を制御する機能を有している。

【0042】上記二次電子検出器10は、測定試料9から放出された二次電子を検出してその検出信号を出力する機能を有するもので、この検出信号は増幅部14により増幅されて画像信号ISとなつて画像信号増幅器15に送られている。

【0043】との画像信号増幅器15は、増幅器14から出力された画像信号ISと掃引信号発生部12で発生した掃引信号SSとによりCRT表示装置16に測定試 20料9の特定部位の画像を拡大表示させる機能を有している。

【0044】一方、パターン検査部2には、CPU部17から設けられ、このCPU部17にA/D変換部18、画像信号記憶部19及びD/A変換部20が接続されている。

【0045】とのうちA/D変換部18は、基準信号発生部11からのクロック信号PS及び掃引信号発生部12で発生した掃引信号SSに基づいてCPU部17から出力された制御信号CS2により増幅部14から出力さ30れた画像信号ISを複数画素例えば512×512画素に分割して画像信号ISのレベル(電圧値)をA/D変換する機能を有している。

【0046】画像信号記憶部19は、A/D変換部18 によって各画素ごとにA/D変換された画像信号DIS をアドレス化してそれらのレベルを記録する機能を有し ている。

【0047】D/A変換部20は、CPU部17の演算 結果をD/A変換して画像信号増幅部15を通してCR T表示装置16に送出する機能を有している。

【0048】上記CPU部17は、図2に示す検査機能メインフローチャートに従い、指定されたアドレスの画像信号DISを画像信号記録部19から読み出し、この画像信号DISに対して各種画像処理を行う演算機能と記憶機能とを有するもので、特に基準画像生成手段2

1、差画像抽出手段22及び欠陥抽出手段23の各機能 を有している。

【0049】とのうち基準画像生成手段21は、図3に 示す基準画像生成フローチャートに従い、複数の良品画 像データに基づいて濃度差や形状差のばらつきに応じた 50 6つの基準画像データ、すなわち欠陥が存在しない良品 パターンの画像データとして例えば上限濃淡画像デー タ、下限濃淡画像データ、上限微分画像データ、下限微 分画像データ、平均濃淡画像データ、平均微分画像デー タを生成する機能を有している。

【0050】具体的に上限濃淡画像データは、例えば図4に示すように複数の良品画像データa1~a4の各画像値のうち座標位置ごとに各最大値から形成される。下限濃淡画像データは、例えば図4に示すように複数の良品画像データの各画像値のうち座標位置ごとに各最小値から形成される。

【0051】上限微分画像データは、良品画像データを 微分処理した画像データの各画像値のうち座標位置ごと に各最大値から形成される。下限微分画像データは、良 品画像データを微分処理した画像データの各画像値のう ち座標位置ごとに各最小値から形成される。

【0052】平均濃淡画像データは、上限濃淡画像データと下限濃淡画像データとを平均処理して形成される。 平均微分画像データは、上限微分画像データと下限微分 画像データとを平均処理して形成される。

【0053】差画像抽出手段22は、図5に示す差画像取得フローチャートに従い、基準画像生成手段21で生成された6つの基準画像データと被検査画像データとの画像間演算を行ってその差画像データを抽出するもので、具体的には、上限濃淡画像データと被検査画像データとの差及び下限濃淡画像データと被検査画像データとの差に基づいて濃淡差画像データを得、かつ上限微分画像データと被検査画像データとの差及び下限微分画像データと被検査画像データとの差に基づいて微分差画像データと被検査画像データとの差に基づいて微分差画像データを得る機能を有している。

【0054】欠陥抽出手段23は、図6に示す欠陥抽出フローチャートに従い、差画像抽出手段22で抽出された差画像データと予め定められたしきい値とを比較して濃度の欠陥部分や形状の欠陥部分を抽出するもので、具体的には、濃淡差画像データと予め定められたしきい値とを比較して濃度の欠陥部分を抽出し、かつ微分差画像データと予め定められたしきい値とを比較して形状の欠陥部分を抽出する機能を有している。

【0055】次に上記の如く構成された装置の作用について説明する。

【0056】SEM本体部1の電子光学鏡筒3の下部には、例えばLSIなどの微小パターンが形成された半導体ウエハなとの測定試料9が設置される。

【0057】電子銃4から電子線束5から放出されると、この電子線束5は、コンデンサレンズ6で縮小され、倍率切換部13からの制御信号CS1に従って走査コイル7によりX-Y方向にラスタ走査され、さらに対物レンズ8で縮小されて測定試料9面に照射される。

【0058】とのように測定試料9面に電子線束5が照射されると、測定試料9面からは二次電子が放出され

る。二次電子検出器10は、との二次電子を検出してその検出信号を出力する。そして、この検出信号は増幅部14により増幅されて画像信号ISとなって画像信号増幅器15に送られる。

【0059】この画像信号増幅器15は、増幅器14から出力された画像信号ISと掃引信号発生部12で発生した掃引信号SSとによりCRT表示装置16に測定試料9の特定部位の画像を拡大表示する。

【0060】これと共に、画像信号 I Sはパターン検査部2のA/D変換部18に送られ、このA/D変換部1108は、CPU部17から出力された制御信号CS2に基づいて画像信号 I SをA/D変換し、ラスタ走査及び走査線分割により例えば512×512 画素に分割し、それぞれのアドレスにおけるA/D変換されたディジタル画像信号を I S(i, j:但しi, j=0, 1, 3, …512)とアドレス化する。

【 0 0 6 1 】画像信号記憶部 1 9 は、A / D変換部 1 8 からのディジタル画像信号(SEM画像)D I Sをアドレスごとに記憶する。

【0062】次に、CPU部17は、画像信号記憶部19に記憶されたディジタル画像信号(以下、被検査画像データと称する)DISに対して演算機能を用いて微小パターンの形状検査を行う。この検査は、画像信号記憶部19に記憶された被検査画像データDISと、同画像信号記憶部19に予め格納された6つの基準画像データとを比較して行う。

【0063】具体的に説明すると、CPU部17は、図

2に示す検査機能メインフローチャートのステップ#1において検査パラメータを読み込み、ステップ#2において被検査画像データと基準画像データとのサイズを再30設定し、ステップ#3において被検査画像データに対する前処理例えば画像読み込み、微分処理、正規化処理を行う。そして、CPU部17は、ステップ#4において基準ファイル枚数の読み込みを行い、ステップ#5~#8において基準画像生成手段21により濃度差や形状差のばらつきに応じた6つの基準画像データを生成する。【0064】具体的に基準画像生成手段21は、良品画像データとして複数の基準画像生成用濃淡画像データをそれぞれ微

【0065】先ず、基準画像生成手段21は、上記図3 に示す基準画像生成フローチャートのステップ#20に おいて図7に示すような例えば近傍領域が±1のマトリックスを用い、このマトリックスを基準画像生成用濃淡画像データに走査して、マトリックスの注目座標(x,y)に当たる基準画像生成用濃淡画像データ上の画像値(濃淡値)と、注目座標(x,y)を中心とする近傍領域(fx,fy)に当たる各画像値を取得する。

分処理した基準生成用微分画像データを用いる。

【0066】次に、基準画像生成手段21は、ステップ #21において、注目座標(x,y)とその近傍領域 (fx.fy)に当たる各画像値のうち最大の画像値(max)を求め、この最大の画像値(max)と上限濃淡画像データ領域の同座標(x,y)の画像値(tmaxとする)とを比較し、max>tmaxであれば、上限濃淡画像データ領域の同座標(x,y)に画像値の最大(max)を格納する。

【0067】次に、基準画像生成手段21は、ステップ#22において、注目座標(x,y)とその近傍領域(fx,fy)に当たる各画像値のうち最小の画像値(min)を下限濃淡画像データ領域の同座標(x,y)の画像値(tminとする)とを比較し、min<tminであれば、下限濃淡画像データ領域の同座標(x,y)に画像値の最小の画像値(min)を格納する。

【0068】次に、基準画像生成手段21は、ステップ#23において上記同様に図7に示すマトリックスを用い、このマトリックスを基準生成用微分画像データに走査して、マトリックスの注目座標(x.y)に当たる基準生成用微分画像データ上の画像値と、注目座標(x.y)を中心とする近傍領域(fx,fy)に当たる各画像値を取得する。

【0069】次に、基準画像生成手段21は、ステップ#24において、注目座標(x,y)とその近傍領域(fx,fy)に当たる各画像値のうち最大の画像値(max)を求め、この最大の画像値(max)と上限微分画像データ領域の同座標(x,y)の画像値(tmaxとする)とを比較し、max>tmaxであれば、上限微分画像データ領域の同座標(x,y)に画像値の最大(max)を格納する。

【0070】次に、基準画像生成手段21は、ステップ#25において、注目座標(x,y)とその近傍領域(fx,fy)に当たる各画像値のうち最小の画像値(min)を下限微分画像データ領域の同座標(x,y)の画像値(tminとする)とを比較し、min<tminであれば、下限微分画像データ領域の同座標(x,y)に画像値の最小の画像値(min)を格納する。

【0071】以上により基準画像生成手段21は、ステップ#26において、6枚の基準画像データのうち上限 濃淡画像データ、下限濃淡画像データ、上限微分画像データ、下限微分画像データを得て、これら画像データを 画像信号記憶部19に保存する。

【0072】次に、基準画像生成手段21は、ステップ#27において、上記同様に図7に示すマトリックスを先に取得した上限濃淡画像データ上に走査し、このマトリックスの注目座標(x,y)に当たる上限濃淡画像データ上の画像値(tmax)を取得する。

【0073】次に、基準画像生成手段21は、ステップ #28において、上記同様に図7に示すマトリックスを 50 先に取得した下限濃淡画像データ上に走査し、このマト リックスの注目座標(x,y)に当たる下限濃淡画像データ上の画像値(tmin)を取得する。

【0074】次に、基準画像生成手段21は、ステップ#29において、上記ステップ#27で取得した上限濃淡画像データ上の画像値(tmax)と上記ステップ#28で取得した下限濃淡画像データ上の画像値(tmin)との平均値(ave)を求め、この平均値(ave)を平均濃淡画像値として平均濃淡画像データ領域の同座標 (x,y)に格納する。

【0075】次に、基準画像生成手段21は、ステップ 10 #30において、上記同様に図7に示すマトリックスを 先に取得した上限微分画像データ上に走査し、このマト リックスの注目座標(x,y)に当たる上限微分画像デ ータ上の画像値(tmax)を取得する。

【0076】次に、基準画像生成手段21は、ステップ#31において、上記同様に図7に示すマトリックスを先に取得した下限微分画像データ上に走査し、このマトリックスの注目座標(x,y)に当たる下限微分画像データ上の画像値(tmin)を取得する。

【0077】次に、基準画像生成手段21は、ステップ 20 #32において、上記ステップ#30で取得した上限微分画像データ上の画像値(tmax)と上記ステップ#31で取得した下限微分画像データ上の画像値(tmin)との平均値(ave)を求め、この平均値(ave)を平均微分画像値として平均微分画像データ領域の同座標 (x,y)に格納する。

【0078】以上により基準画像生成手段21は、ステップ#33において、6枚の基準画像データのうち残りの平均濃淡画像データ、平均微分画像データを得て、これら画像データを画像信号記憶部19に保存する。

【0079】次に、CPU部17は、図2に示す検査機能メインフローチャートのステップ#9において、6枚の基準画像データのうち平均微分画像データを2値化し、図8(a)に示すような基準平均微分2値化画像データを生成する。

【0080】次に、CPU部17は、画像信号記憶部19に記憶されている濃淡の被検査画像データを読み出し、この被検査画像データに対して2値化し、図8(b)に示すような被検査微分2値化画像データを生成する。【0081】次に、CPU部17は、ステップ#10に40おいて、図8(a)(b)に示す基準平均微分2値化画像データと被検査微分2値化画像データとの各画像位置をシフトさせながら、これら画像データの各画像値の排他的論理和(XOR)を求め、との排他的論理和(XOR)が最小(差異最小)となる位置を求める精密位置合わせを*

maxtemp = p - max

を計算し、maxtemp<0となる場合、maxtemp=0とする。

【0090】次に、差画像抽出手段22は、ステップ#53において、図10(a)に示すような濃淡の被検査画

* 行う。

(9)

【0082】具体的にCPU部17は、図9に示す精密位置合わせフローチャートに従い、ステップ#40において基準平均微分2値化画像データと被検査微分2値化画像データとのサイズを再設定し、次のステップ#41において差異最小カウンタを初期化し、次のステップ#41において差異カウンタを初期化する。

【0083】次に、CPU部17は、ステップ#43において、基準平均微分2値化画像データと被検査微分2値化画像データとの同座標値の排他的論理和(XOR)を求める。

【0084】次に、CPU部17は、ステップ#44に おいてXORの計算結果と遮蔽マスク画像の同座標値の 論理積(AND)を計算し、次のステップ#45におい てANDの結果を差異カウンタに加算する。

【0085】次に、CPU部17は、ステップ#46において差異カウンタのカウント値と差異最小カウンタのカウント値とを比較し、差異カウンタのカウント値が差異最小カウンタのカウント値よりも小さければ、ステップ#47に移って基準画像シフト量を記憶し、次のステップ#48において差異カウンタのカウント値を差異最小カウンタのカウント値に設定する。これにより、基準平均微分2値化画像データと被検査微分2値化画像データとが位置合わせされる。

【0086】次に、CPU部17の差画像抽出手段22は、図2に示す検査機能メインフローチャートのステップ#11において、濃度差や形状差の許容範囲情報を持つ各基準画像データと被検査画像データとの各画像間演算を行って、濃度異常や形状異常を含む差画像を抽出する

【0087】具体的に差画像抽出手段22は、図5に示す差画像取得フローチャートに従い、ステップ#50において、図10(a)に示すような濃淡の被検査画像データに対して上記同様に図7に示すマトリックスを走査し、とのマトリックスの注目座標(x,y)に当たる画像値(pとする)を取得する。

【0088】次に、差画像抽出手段22は、ステップ#51において、図10(b)に示すような上限濃淡画像データの注目座標(x, y) に位置合わせデータの座標(dx, dy) を加えた座標(x+dx, y+dy)の画像値(maxとする)を取得する。

【0089】次に、差画像抽出手段22は、ステップ#52において、濃淡の被検査画像データの画像値(p)と上限濃淡画像データの画像値(max)との差分を濃度上限差(maxtemp)として設定する。すなわち、

...(1)

像データに対して上記同様に図7に示すマトリックスを 走査し、このマトリックスの注目座標(x,y)に当た る画像値(pとする)を取得する。

【0091】次に、差画像抽出手段22は、ステップ#

54において、下限濃淡画像データの注目座標(x, y) に位置合わせデータの座標(dx, dy) を加えた 座標 (x+dx, y+dy)の画像値 (minとする)を 取得する。

mintemp=min-p

を計算し、mintemp<0となる場合、mintemp=0とす

【0093】次に、差画像抽出手段22は、ステップ#※

d = maxtemp + mintemp

する。

【0094】図11は以上のように求められる濃淡差画 像データの作用を示す模式図であつて、濃度上限差(ma xtemp) 及び濃度下限差 (mintemp) と被検査画像データ の画像値(p)との濃淡差(d)が示されている。 【0095】次に、差画像抽出手段22は、ステップ# 57において、濃淡の被検査画像データの注目座標 (x,y)の画像値(pとする)を取得する。

maxtemp = p - max

を計算し、maxtemp<0となる場合、maxtemp=0とす る.

【0098】次に、差画像抽出手段22は、ステップ# 60において、濃淡の被検査画像データに対して上記同 様に図7に示すマトリックスを走査し、このマトリック スの注目座標(x,y)に当たる画像値(pとする)を 取得する。

【0099】次に、差画像抽出手段22は、ステップ#☆ mintemp=min-p

を計算し、mintemp<0となる場合、mintemp=0とす

【0101】次に、差画像抽出手段22は、ステップ#◆

d = maxtemp + mintemp

を求め、微分差画像データ領域の座標(x,y)に格納 する。

【0102】次に、差画像抽出手段22は、ステップ# 64において、濃淡差画像データ領域の座標(x,y) の画像値(ndとする)と、微分差画像データ領域の座 標(x,y)の画像値(bdとする)とを取得し、これ ら画像値(nd)と画像値(bd)を比較する。

【0103】 この比較の結果、画像値(nd)が画像値 40 (bd) よりも小さくnd < bd であれば、差画像抽出 手段22は、ステップ#65に移ってndを最小差画像 領域の座標(x,y)に格納、すなわち濃淡差画像値を 絶対値差画像値として出力する。

【0104】又、上記比較の結果、画像値(nd)が画 像値(bd)よりも大きくnd≥bdであれば、差画像 抽出手段22は、ステップ#66に移ってbdを最小差 画像領域の座標(x,y) に格納、すなわち微分差画像 値を絶対値差画像値として出力する。

【0105】以上により差画像抽出手段22は、ステッ 50 1において、濃淡差画像データ上の画像値(np)と予

*【0092】次に、差画像抽出手段22は、ステップ# 55において、濃淡の被検査画像データの画像値(p)

と下限濃淡画像データの画像値(min)との差分を濃度 下限差 (mintemp) として設定する。すなわち、

...(2)

※56において、濃度上限差 (maxtemp) と濃度下限差 (m intemp) とを加算し、濃淡差(d)

...(3)

を求め、濃淡差画像データ領域の座標(x, y) に格納 10★【0096】次に、差画像抽出手段22は、ステップ# 58において、上限微分画像データの注目座標(x, y)に位置合わせデータの座標(dx, dy)を加えた・ 座標 (x+dx, y+dy)の画像値 (maxとする) を 取得する。

> 【0097】次に、差画像抽出手段22は、ステップ# 59において、濃淡の被検査画像データの画像値(p) と上限微分画像データの画像値(max)との差分を微分 上限差(maxtemp)として設定する。すなわち、

...(4)

20☆61において、下限微分画像データの注目座標(x, y) に位置合わせデータの座標(dx. dy) を加えた。 座標 (x+dx, y+dy) の画像値 $(min \ge tau)$ を 取得する。

【0100】次に、差画像抽出手段22は、ステップ# 62において、濃淡の被検査画像データの画像値(p) と下限微分画像データの画像値(min)との差分を微分 下限差 (mintemp) として設定する。すなわち、

...(5)

◆63において、上限微分値(maxtemp)と下限微分値(m 30 intemp) とを加算し、微分差(d)

...(6)

プ#67において、濃淡差画像データ、微分差画像デー タ及び絶対値差画像データを取得して画像信号記憶部1 9に保存する。

【0106】次に、CPU部17の欠陥抽出手段23 は、図2に示す検査機能メインフローチャートのステッ プ#12において、差画像抽出手段22で抽出された濃 淡差画像データ、微分差画像データ及び絶対値差画像デ ータを受け取り、このうち濃淡差画像データと予め定め られたしきい値とを比較して濃度の欠陥部分を抽出し、 かつ微分差画像データと予め定められたしきい値とを比 較して形状の欠陥部分を抽出する。

【0107】具体的に欠陥抽出手段23は、図6に示す 欠陥抽出フローチャートに従い、ステップ#70におい て、上記同様に図7に示すマトリックスを濃淡差画像デ ータ上に走査し、このマトリックスの注目座標(x. y) に当たる画像値(npとする)を取得する。

【0108】次に、欠陥抽出手段23は、ステップ#7

め定められた2値化しきい値(isp.Sth:欠陥出力しき い値)とを比較し、np<isp.Sthであれば、ステップ #72に移って欠陥ではないと判断し、「0」を濃淡欠 陥抽出画像領域の座標(x,y) に格納する。

【0109】又、画像値(np)と2値化しきい値(is p.Sth) との比較の結果、n p ≧ isp.Sth であれば、欠 陥抽出手段23は、ステップ#73に移って欠陥である と判断し、画像値(np)を濃淡欠陥抽出画像領域の座 標(x, y) に格納する。

【0110】次に、欠陥抽出手段23は、ステップ#7 10 4 において、上記同様に図7に示すマトリックスを微分 差画像データ上に走査し、このマトリックスの注目座標 (x, y) に当たる画像値(np) を取得する。

【0111】次に、欠陥抽出手段23は、ステップ#7 5 において、微分差画像データ上の画像値(np)と予 め定められた2値化しきい値(isp.Sth)とを比較し、 np<isp.Sth であれば、ステップ#76に移って欠陥 ではないと判断し、「0」を微分欠陥抽出画像領域の座 標(x,y)に格納する。

【0112】又、画像値(np)と2値化しきい値(is 20 p.Sth) との比較の結果、p≧isp.Sthであれば、欠陥抽 出手段23は、ステップ#77に移って欠陥であると判 断し、画像値(np)を微分欠陥抽出画像領域の座標 (x,y) に格納する。

【0113】次に、欠陥抽出手段23は、ステップ#7 8 において、濃淡欠陥抽出画像データ及び微分欠陥抽出 画像データを画像信号記憶部19に保存する。

【0114】なお、欠陥抽出手段23は、上記同様に図 7に示すマトリックスを絶対値差画像データ上に走査 し、このマトリックスの注目座標(x,y)に当たる画 30 像値(npとする)を取得する。

【0115】次に、欠陥抽出手段23は、絶対値差画像 データ上の画像値(np)と予め定められた2値化しき い値(isp.Sth)とを比較し、np<isp.Sthであれば、 欠陥ではないと判断して「0」を絶対値欠陥抽出画像領 域の座標(x, y) に格納し、かつn p≥isp.Sthであ れば、欠陥であると判断して画像値(np)を絶対値欠 陥抽出画像領域の座標(x,y)に格納する。

【0116】以上のように濃淡欠陥抽出画像データ、微 分欠陥抽出画像データ、絶対値欠陥抽出画像データを抽 40 出すると、CPU部17は、これら画像データにおける 抽出領域の特徴、すなわち抽出領域の総面積、最大領域 の面積、最大領域の縦横比、抽出領域の総数を計測し、 これらの特徴について予め定められた良否判別基準と比 較して良否を判定する。

【0117】このように上記第1の実施の形態において は、複数の良品画像データに基づいて濃度差や形状差の ばらつきに応じた基準画像データを生成し、この基準画 像データと被検査画像データとの画像間演算を行ってそ の差画像データを抽出し、この差画像データと予め定め 50 と下限濃淡画像データの画像値(min)との差分mintemp

られたしきい値とを比較して濃度の欠陥部分や形状の欠 陥部分を抽出するので、微小パターンの形状検査を自動 的に高精度に行うことができる。例えば、SEM画像に 特有の二次電子画像の輝度分布むらや変動に左右される ことなく、微小パターンの形状欠陥のみを抽出して検査 でき、LSI、超LSIなどの半導体プロセスに適用し た場合、製品の評価及び検査を容易かつ高精度に行うと とができる。

【0118】なお、上記第1の実施の形態は、次の通り 変形してもよい。

【0119】例えば、基準画像データの生成において図 7に示すような近傍領域を注目画素の±1画素の領域と したが、これに限らず微小パターンの良品許容範囲の幅 に応じて設定してよい。

【0120】又、基準画像データと被検査画像データと の比較のための位置合わせを示す図8では、位置決め移 動幅をmx、myとも1としているが、これに限らず2 枚の画像の位置ずれ量に合わせて移動量を設定してもよ 64

【0121】又、位置決めに微分二値画像データを用い ているが、これに限らず微分画像データや濃淡画像デー タを2値化した画像データ、濃淡画像データそのものを 位置決めに用いてもよい。

【0122】又、測定試料9としてLSIバターンに限 らず、μmオーダの測定であれば如何なる測定試料に対 しても微小パターンの形状検査に適用できる。

【0123】さらに、差画像抽出手段22は、図12に 示すフローチャートを実行するようにしてもよい。すな わち、差画像抽出手段22は、ステップ#80におい て、図10(a) に示すような濃淡の被検査画像データに 対して上記同様に図7に示すマトリックスを走査し、と のマトリックスの注目座標 (x, y) に当たる画像値 (p)を取得する。

【0124】次に、差画像抽出手段22は、ステップ# 81において、図10(b) に示すような上限濃淡画像デ ータの注目座標(x,y)に位置合わせデータの座標 (dx, dy)を加えた座標(x+dx, y+dy)の 画像値(max)を取得する。

【0125】次に、差画像抽出手段22は、ステップ# 82において、濃淡の被検査画像データの画像値(p) と上限濃淡画像データの画像値(max)との差分maxtemp = p - max を濃度上限差 (maxtemp) として設定する。 【0126】次に、差画像抽出手段22は、ステップ# 83において、下限濃淡画像データの注目座標(x, y) に位置合わせデータの座標(dx, dy) を加えた 座標 (x+dx, y+dy)の画像値 (minとする)を 取得する。

【0127】次に、差画像抽出手段22は、ステップ# 84において、濃淡の被検査画像データの画像値(p)

=min-pを濃度下限差 (mintemp) として設定する。 【0128】次に、差画像抽出手段22は、ステップ# 85において、濃度上限差 (maxtemp) と濃度下限差 (m intemp) とを加算し、濃淡差 d = maxtemp+ mintempを 求め、濃淡差画像データ領域の座標(x,y)に格納する

【0129】次に、差画像抽出手段22は、ステップ# 86において、微分の被検査画像データの注目座標 (x, y)の画像値(pとする)を取得する。

【0130】次に、差画像抽出手段22は、ステップ# 87において、上限微分画像データの注目座標 (x, y) に位置合わせデータの座標(dx, dy) を加えた 座標(x+dx, y+dy)の画像値(maxとする)を 取得する。

【0131】次に、差画像抽出手段22は、ステップ# 88において、微分の被検査画像データの画像値(p) と上限微分画像データの画像値(max)との差分maxtemp = p - maxを微分上限差(maxtemp)として設定する。

【0132】次に、差画像抽出手段22は、ステップ# 89において、下限微分画像データの注目座標(x, y) に位置合わせデータの座標(dx, dy) を加えた 座標 (x+dx, y+dy) の画像値 (min と する) を 取得する。

【0133】次に、差画像抽出手段22は、ステップ# 90において、微分の被検査画像データの画像値(p) と下限微分画像データの画像値(min)との差分mintemp =min-pを微分下限差(mintemp)として設定する。 【0134】次に、差画像抽出手段22は、ステップ# 91において、上限微分値(maxtemp)と下限微分値(m intemp) とを加算し、微分差 d = maxtemp+mintempを求 30 め、微分差画像データ領域の座標(x,y)に格納す る。

【0135】以上により差画像抽出手段22は、濃淡差 画像データ、微分差画像データを取得して画像信号記憶 部19に保存する。

【0136】(2) 次に、本発明の第2の実施の形態につ いて図面を参照して説明する。なお、図1と同一部分に は同一符号を付してその詳しい説明は省略する。

【0137】図13は微小パターン形状検査装置の構成 図である。

【0138】上記CPU部17は、指定されたアドレス の画像信号DISを画像信号記録部19から読み出し、 この画像信号DISに対して各種画像処理を行う演算機 能と記憶機能とを有するもので、特に検査領域設定手段 30、濃度ピーク点列手段31、取得濃度データ手段3 2及び欠陥判定手段33の各機能を有している。

【0139】このうち検査領域設定手段30は、測定試 料9上に形成されている微小パターンの形状、例えば図 14及び図15に示すような半導体のレジスト穴パター

ようなテーパ検査領域QをSEM本体部1で得られる画 像データに対して設定する機能を有している。

【0140】CCで、テーバ検査領域Qは、楕円1と楕 円2とから成るもので、これら楕円1及び楕円2の各バ ラメータは楕円1(長径A1、短径B1)、楕円2(長 径A2、短径B2)となっており、基準となるレジスト 穴パターン40のサイズのばらつき、形状歪み、パター ンの位置合わせ誤差を考慮して、楕円1がレジスト穴バ ターン40を含むように、かつ楕円2がレジスト穴パタ ーン40に含まれるように事前に設定される。

【0141】濃度ピーク点列手段31は、検査領域設定 手段30で設定されたテーパ検査領域Qの湾曲方向を横 切る部分、例えば図16に示すようにテーバ検査領域Q の各楕円を横切る各直線L1、L2 、…、Lnを所定 角度毎に設定し、これら直線L1 、L2、…、Ln上 の各輝度分布からそれぞれ各濃度ピーク位置を求めて図 17に示すような濃度ビーク点列 (Xi. Yi) を取得 する機能を有している。なお、iは1~Mである。

【0142】取得濃度データ手段32は、図18に示す 20 ように濃度ピーク点列手段31で求められた濃度ピーク 点列(Xi, Yi) に対して略垂直方向すなわち各直線 Pi、Pi+1、…、で、かつ図19に示すようにピーク 座標 (Xi+1, Yi+1) の濃度ピーク点を含む範囲 (以 下、濃度データ取得範囲と称する) ± αでの濃度データ を取得する機能を有している。

【0143】 この取得濃度データ手段32は、濃度デー タ取得範囲±αをレジスト穴パターン40の凹凸状のダ レ量、レジスト穴パターン40の歪み量、そのサイズ変 動に応じて設定する機能を有している。

【0144】欠陥判定手段33は、取得濃度データ手段 32で取得された各濃度データに対してそれぞれ所定の 方向に輝度を加算し、この濃度加算値の最大、最小、平 均、分散を演算して求め、これら最大、最小、平均、分 散値と予め設定された良否判定基準とを比較してレジス ト穴パターン40の良否を判定する機能を有している。 【0145】次に上記の如く構成された装置の作用につ いて説明する。

【0146】SEM本体部1の電子光学鏡筒3の下部に は、例えばLSIなどの微小なレジスト穴パターン40 が形成された半導体ウエハ等の測定試料9が設置され る。

【0147】電子銃4から電子線束5から放出される と、この電子線束5は、上記第1の実施の形態と同様 に、コンデンサレンズ6で縮小され、走査コイル7によ りX-Y方向にラスタ走査され、さらに対物レンズ8で 縮小されて測定試料9面に照射される。

【0148】 この測定試料9面から放出される二次電子 は、二次電子検出器10により検出されてその検出信号 が増幅部14を通って画像信号 I Sとして画像信号増幅 ン40に応じた湾曲状の検査領域、例えば図16に示す 50 器15に送られ、この画像信号増幅器15によりレジス (13)

ト穴パターン40がCRT表示装置16で拡大表示され み。

【0149】これと共に、画像信号ISは、A/D変換部18によりA/D変換され、ラスタ走査及び走査線分割により例えば512×512画素に分割されて、それぞれのアドレスにおけるディジタル画像信号をIS

(i, j:但しi, j=0, 1, 3, …512) とアドレス化する。画像信号記憶部19は、これらディジタル画像信号(SEM画像)DISをアドレスごとに記憶する。

【0150】次に、CPU部17は、画像信号記憶部19に記憶されたディジタル画像信号(被検査画像データ)DISに対して演算機能を用いてレジスト穴パターン40の検査を行う。

【0151】上記図14及び図15はSEM本体部1で・ 得られたレジスト穴パターン40の画像例であり、図1 4から図15の順番でレジスト穴パターン40の縁のレ ジスト形状のダレ(テーパ)が顕著となり、これにより SEM画像上での画像濃度に変化が生じている。

【0152】テーパが正常な図14に示すSEM画像で 20 は穴縁部のテーパを示す輝度が均一で幅も狭い。ところが、テーパが異常となる図15に示すSEM画像では輝度の均一性も崩れ、幅も狭く、輝度自体も高くなっている。

【0153】とのようなレジスト穴パターン40の穴テーバ検査では、穴縁のテーパの状態を反映するSEM画像の穴縁部の輝度を正確に評価する。

【0154】先ず、画像信号記憶部19に記憶された被検査画像データDIS中には、レジスト穴パターン40が複数存在するので、これらレジスト穴パターン40の 30うち計測するレジスト穴パターン40を選択し、その位置を特定する。

【0155】CPU部17は、図20に示す穴画像をテンプレート画像又は基準画像Sとして図14又は図15に示す被検査画像データDISとの正規化相互相関演算を行い、類似度が指定値以上の位置を図21の「+」に示すような穴パターン位置(Cx, Cy)とする。

【0156】次に、CPU部17の検査領域設定手段30は、選択・位置特定されたレジスト穴パターン40の穴パターン位置(Cx, Cy)を中心に、図16に示す40テーパ検査領域Qの各楕円1、2を図22に示すようにレジスト穴パターン40に対して設定する。

【0157】次に、検査領域設定手段30は、レジスト 穴パターン40に対して設定したテーパ検査領域Qにおいて、楕円1の内部でかつ楕円2の外側となる領域を検 査領域として設定する。

【0158】次に、濃度ピーク点列手段31は、レジスト穴パターン40に対して設定したテーパ検査領域Qにおいて、例えば図16に示すように穴パターン40の中心(C_* , C_*)から各楕円1、2を横切る各直線L<math>1、

L2、…、Lnを所定角度毎に設定し、これら直線L 1、L2、…、Ln上の各輝度分布を取得する。図23 (a)~同図(c)はそれぞれ各直線L1、L2、…、Ln上 の各輝度分布を示している。

【0159】次に、濃度ビーク点列手段31は、各直線 L1、L2、…、Ln上の各輝度分布からそれぞれ各濃 度ピーク位置を求め、図17に示すようなレジスト穴バ ターン40のテーバ部の濃度ビーク点列(Xi, Yi) を取得する。

【0160】次に、取得濃度データ手段32は、濃度ビーク点列手段31で求められた濃度ビーク点列(Xi, Yi)に対して略垂直方向、例えば図18に示すように濃度ビーク点列(Xi, Yi)(Xi+1, Yi+1)(Xi+2, Yi+2)(Xi+3, Yi+3)で説明すると、各濃度ビーク点(Xi, Yi)と(Xi+1, Yi+1)とを結ぶ傾きAiの直線Kiに対して垂直方向に交わる傾き1/Aiの直線Piを求める。

【0161】同様に、各濃度ピーク点(Xi+1、Yi+1)と(Xi+2、Yi+2)とを結ぶ傾きAi+1の直線Ki+1に対して垂直方向に交わる傾き1/Ai+1の直線Pi+1を求める。さらに、各濃度ピーク点(Xi+2、Yi+2)と(Xi+3、Yi+3)とを結ぶ傾きAi+2の直線Ki+2に対して垂直方向に交わる傾き1/Ai+2の直線Pi+2を求める。

【 0 1 6 2 】以下、同様に、各濃度ピーク点 (XM-1, YM-1) と (XM, YM) とを結ぶ傾き A M-1の直線 KM-1 に対して垂直方向に交わる傾き 1 / A M-1の直線 PM-1を求める。

【0163】次に、取得濃度データ手段32は、各直線 $Pi \sim PM$ -1でそれぞれ図19に示すように各ピーク座 標 $(Xi+1, Yi+1) \sim (XM-1, YM-1)$ の濃度ピーク点 を含む濃度データ取得範囲 $\pm \alpha$ での濃度データを取得する。

【0164】このように濃度データ取得範囲±αをテーパ輝度のピーク座標より再設定することにより、レジスト穴パターン40のサイズ変動や形状歪みに左右されることなく、レジスト穴パターン40のテーパ部分の輝度情報を正確に取得できる。

【0165】図24は濃度データ取得範囲 $\pm \alpha$ におけるレジスト穴パターン40のテーパ部分の輝度情報を示す模式図であり、取得濃度データ手段32は、取得濃度データ $G_1(n)$ (とこで、nは $1\sim 2\times \alpha+1$)を展開・整列し、テーパ部の輝度画像を生成する。

【0166】次に、欠陥判定手段33は、取得濃度データ手段32で取得された各取得濃度データに対してそれぞれ所定の方向に輝度を加算し、この濃度加算値の最大、最小、平均、分散を演算して求める。

【0167】次に、欠陥判定手段33は、図25及び図26に示すように最大、最小、平均、分散値と予め設定された良否判定基準とを比較してレジスト穴パターン40の良否を判定する。

【0168】このように上記第2の実施の形態において は、レジスト穴パターン40の形状に応じたテーパ検査 領域Qを被検査画像データDISに対して設定し、この テーバ検査領域Qを横切る各直線上の各輝度分布に基づ いて濃度ピーク点列を求め、この濃度ピーク点列に対し て略垂直方向でかつ濃度ピーク点を含む濃度データ取得 範囲±αでの濃度データを取得し、この各濃度データに 対して濃度加算値の最大、最小、平均、分散などを演算 して求め、これら値と予め設定された良否判定基準とを 比較してレジスト穴パターン40の良否を判定するよう にしたので、多様な形状で変形や歪みのあるレジスト穴 バターン40のテーパ部の欠陥部のみを抽出し、高精度 で定量的にかつ検査を自動的に行うことができる。これ により、LSI、超LSIなどの半導体プロセスに適用 した場合、製品の評価及び検査を容易かつ高精度に行う ことができる。

【0169】なお、上記第2の実施の形態は、次の通り 変形してもよい。

【0170】例えば、測定試料9としてはレジスト穴パターン40のように楕円に近い形状のものとしているが、これに限らずパターン形状の輪郭が閉曲線ならば凸体であつてもよい。又、パターン形状の輪郭が閉曲線でなければ、凸体の一部であるならば検査に適用できる。【0171】又、テーパ部の濃度ピーク座標をテーパ部の指定範囲の輝度展開のみに利用したが、濃度ピーク座標の点列を使って測定試料9の幅W、高さH、縦横比H/W、周囲長P、面積S、真円度P²/(4πS)などを求め、測定試料9の形状評価つまり歪み評価に用いることができる。

【0172】又、測定試料9としてLSIパターンを例にとって説明したが、これに限らずμmオーダの測定であれば如何なる測定試料に対しても微小パターンの形状検査に適用できる。

【0173】(3) 次に、本発明の第3の実施の形態について図面を参照して説明する。なお、図13と同一部分には同一符号を付してその詳しい説明は省略する。

【0174】図27は微小パターン形状検査装置の構成図である。

【0175】上記CPU部17は、画像信号記憶部19 に記憶された被検査画像データDISを読み出し、これ 40 おバターン形状に 5被検査画像データDISから測定試料9上に形成され 化による影響のため 150 から測定式料9上に形成され 化による影響のため 動が含まれている。 カン形状をみを評価 にスペクトル処理を施し、一方、測定試料9上に形成されている複数の半 導体のレジスト穴パターン40から選定された基準とするレジスト穴パターン40の形状に応じた検査領域内の 輝度分布に基づいて求められる濃度ビーク点列に対して ロ181】パター 関度分布に基づいて求められる濃度ビーク点列に対して 明すると、図28に 形の周辺に沿って過ようとする濃度ビーク点列と基準とする濃度ビーク点列 50 することができる。

とを比較してレジスト穴バターン40の評価を行う機能を有するもので、検査領域設定手段30、濃度ピーク点列手段31、フィルタ処理手段50及び評価手段51の各機能を有している。

【0176】とのうち検査領域設定手段30、濃度ピーク点列手段31及びフィルタ処理手段50は、第1と第2の形状処理手段を兼用して構成するもので、評価しようとするレジスト穴パターン40の形状に応じた検査領域内の輝度分布に基づいて求められる濃度ピーク点列に対してフィルタ処理を施すことにより第1の形状処理手段を構成し、基準とするレジスト穴パターン40の形状に応じた検査領域内の輝度分布に基づいて求められる濃度ピーク点列に対してフィルタ処理を施すことにより第2の形状処理手段を構成するものとなる。

【0177】CCで、検査領域設定手段30及び濃度ビーク点列手段31は、上記第3の実施の形態と同様の機能を有するもので、検査領域設定手段30は、評価しようとする半導体のレジスト穴バターン40又は標準のレジスト穴バターン40に応じた湾曲状の検査領域、例えば上記図16に示すようなテーパ検査領域QをSEM本体部1で得られる画像データに対して設定する機能を有している。

【0178】 濃度ビーク点列手段31は、検査領域設定手段30により設定されたテーバ検査領域Qの湾曲方向を横切る部分、例えば図16に示すようにテーバ検査領域Qの各楕円を横切る各直線L1、L2、…、Lnを所定角度毎に設定し、これら直線L1、L2、…、Ln上の各輝度分布からそれぞれ各濃度ビーク位置を求めて図17に示すような濃度ビーク点列(Xi, Yi)を取得する機能を有している。

【0179】フィルタ処理手段50は、濃度ピーク点列手段31により取得された評価しようとする濃度ピーク点列(Xi, Yi)又は基準の濃度ピーク点列(Xi, Yi)に対してローパスフィルタ処理を施すもので、具体的には濃度ピーク点列(Xi, Yi)をフーリエ級数展開し、所定の次数までのフーリエ係数を用いて形状復元する機能を有している。

【0180】すなわち、濃度ピーク点列手段31により取得された各濃度ピーク点列(Xi, Yi)により得られるパターン形状は、SEM画像特有のノイズ、輝度変化による影響のためにそのパターン形状に微細な形状変動が含まれている。このような微細な形状変動は、パターン形状歪みを評価するうえに阻害する要因となるためにスペクトル処理により取り除き整形することが必要であり、このために濃度ピーク点列(Xi, Yi)に対してフィルタ処理を施す。

【0181】バターン形状のスペクトル処理について説明すると、図28に示すような閉曲線図形の形状は、図形の周辺に沿って測った長さtによって次のように表現するとよができる

27

[0182]

x = f x (t)y = f y (t)

CCC、 $0 \le t \le L$ 、又、fx(0) = fx(L)、fy (0) = f y (L) であり、L は閉曲線を一周する長 さである。

【0183】上記式(7)及び(8)は、閉曲線を一周する長 さしを周期とする周期関数であるので、フーリエ級数に 展開することができる。すなわち、fx(t)、fy (t)のフーリエ級数展開によってフーリエ係数の集合 10 (スペクトル)が得られる。 とのフーリエ係数の集合で は、フーリエ係数の高次部分ほど図形の細部の形状につ いての情報が含まれている。

【0184】従って、フーリエ級数展開した後に適当な 次数までの係数を用いて図形を復元することで微細な形 状変動を除去することができる。この使用するフーリエ 級数の係数の次数は、被検査画像データDISのS/N などによって実験的に決定される。

【0185】とのうちフィルタ処理手段50によりフィ ルタ処理された基準の濃度ピーク点列(Xi, Yi) は、CPU部17の指令によって基準形状登録部52に 予め登録される。

【0186】評価手段51は、フィルタ処理手段50に よってフィルタ処理、すなわちフーリエ級数展開した後 に適当な次数までの係数を用いて図形を復元された評価 しようとする濃度ピーク点列と基準形状登録部52から 読み出した標準の濃度ピーク点列とを比較してレジスト 穴パターン40の評価を行う機能を有している。

【0187】この評価手段51は、評価しようとする濃 度ピーク点列と基準の濃度ピーク点列とを比較すると き、これら評価しようとする濃度ピーク点列と基準の濃 度ピーク点列とによりそれぞれ形成される各パターンサ イズの横幅が同じになるように、精度を必要とするとき には各バターンサイズの縦横比が同じになるように調整 する機能を有している。

【0188】又、評価手段51は、評価しようとする濃 度ピーク点列と基準の濃度ピーク点列とを比較すると き、これら評価しようとする濃度ピーク点列と基準の濃 度ピーク点列とを重ね合わせ、これら濃度ピーク点列と 基準とする濃度ピーク点列との各パターン間のずれ量 d 40 の総和をレジスト穴パターン40の形状歪み評価値とす る機能を有している。

【0189】ずれ量dの評価関数gでは、微細なずれを 無視するために、例えば

 $-\alpha < d < +\alpha \rightarrow g(d) = 0$

となるような不感帯を設定するパラメータ±αを設定し たり、又大きなずれを強調評価するために、

g(d) = g * g又は

g(d) = exp(q)

...(7)

... (8)

などの演算を実行している。

【0190】又、評価手段51は、レジスト穴パターン 40の形状歪み評価値と予め設定された良否判別基準値 とを比較し、レジスト穴バターン40の良否判定を行う 機能を有している。

【0191】次に上記の如く構成された装置の作用につ いて説明する。

【0192】SEM本体部1の電子光学鏡筒3の下部に は、例えばLSIなどの微小なレジスト穴パターン40 が形成された半導体ウエハ等の測定試料9が設置され

【0193】電子銃4から電子線束5から放出される と、この電子線束5は、上記第1の実施の形態と同様 に、コンデンサレンズ6で縮小され、走査コイル7によ りX-Y方向にラスタ走査され、さらに対物レンズ8で 縮小されて測定試料9面に照射される。

【0194】この測定試料9面から放出される二次電子 20 は、二次電子検出器10により検出されてその検出信号 が増幅部14を通って画像信号 ISとして画像信号増幅 器15に送られ、この画像信号増幅器15によりレジス ト穴パターン40がCRT表示装置16で拡大表示され

【0195】これと共に、画像信号ISは、A/D変換 部18によりA/D変換され、ラスタ走査及び走査線分 割により例えば512×512画素に分割されて、それ ぞれのアドレスにおけるディジダル画像信号をIS

(i, j:但しi, j=0, 1, 3, …512) とアド レス化する。画像信号記憶部19は、これらディジタル 画像信号(SEM画像)DISをアドレスごとに記憶す

【0196】次に、CPU部17は、画像信号記憶部1 9に記憶されたディジタル画像信号(被検査画像デー タ)DISに対して演算機能を用いてレジスト穴パター ン40のパターン形状の歪みの評価を行う。

【0197】上記図14及び図15はSEM本体部1で 得られたレジスト穴パターン40の画像例であり、図1 4に示す小判型をしたレジスト穴パターン40を基準形 状として選定した場合、図15に示すレジスト穴パター ン40は、その穴の縁のレジスト形状の歪みが顕著とな っている。

【0198】以下、図15に示すレジスト穴パターン4 0のレジスト形状の歪みの評価について説明する。

【0199】先ず、画像信号記憶部19に記憶された被 検査画像データDIS中には、レジスト穴パターン40 が複数存在するので、これらレジスト穴パターン40の うち基準とするレジスト穴パターン40を選択し、その 50 位置を特定する。

【0200】CPU部17は、上記図20に示す穴画像 をテンプレート画像又は基準画像Sとして図14又は図 15に示す被検査画像データDISとの正規化相互相関 演算を行い、類似度が指定値以上の位置を図21の 「+」に示すような穴パターン位置(Cx, Cy)とす

【0201】このとき、複数のレジスト穴パターン40 の相対位置から画像の傾きがチェックされ、必要であれ ば傾き補正が行われる。

【0202】次に、CPU部17の検査領域設定手段3 10 0は、選択・位置特定された基準のレジスト穴パターン 40の穴パターン位置 (Cx, Cy) を中心に、図16 に示すテーパ検査領域Qの各楕円1、2を図22に示す ようにレジスト穴パターン40に対して設定し、とのテ ーバ検査領域Qにおいて、楕円1の内部でかつ楕円2の 外側となる領域を検査領域として設定する。

【0203】次に、濃度ピーク点列手段31は、基準の レジスト穴パターン40に対して設定したテーパ検査領 域Qにおいて、例えば図16に示すように穴パターン4 0 の中心(Cx, Cy)から各楕円1、2 を横切る各直 20 線し1、し2、…、しnを所定角度毎に設定し、上記図 23(a)~同図(c)に示すように各直線L1、L2、…、 Ln上の各輝度分布を取得する。

【0204】次に、濃度ピーク点列手段31は、各直線 L1、L2、…、Ln上の各輝度分布からそれぞれ各濃 度ピーク位置を求め、上記図17に示すような基準とす るレジスト穴パターン40のテーパ部の濃度ピーク点列 (Xi, Yi)を取得する。

【0205】次に、フィルタ処理手段50は、濃度ピー ク点列手段31により取得された基準の濃度ピーク点列 30 (Xi, Yi) に対してローパスフィルタ処理、すなわ ち濃度ピーク点列(Xi,Yi)をフーリエ級数展開 し、所定の次数までのフーリエ係数を用いて形状復元す る。とのとき使用するフーリエ級数の係数の次数は、被 検査画像データDISのS/Nなどによって実験的に決 定される。

【0206】図29(a)(b)(c)はそれぞれ基準の濃度ビ ーク点列(Xi,Yi)の原形状、高次スペクトル(1 0次まで)による形状復元、低次スペクトル(2次ま で)による形状復元を示す模式図である。これら図から 40 分かるように高次スペクトルによる形状復元では、濃度 ピーク点列(Xi, Yi)の原形状に近い形状が復元さ れ、低次スペクトルによる形状復元では、濃度ピーク点 列(Xi, Yi)の原形状からずれて楕円に近い形状で 復元される。とのような形状復元があるので、フーリエ 級数の係数の次数は、被検査画像データDISのS/N などによって実験的に決定される。

【0207】 このように濃度ピーク点列 (Xi, Yi) に対してフーリエ級数展開し、所定の次数までのフーリ 有のノイズ、輝度変化による影響のために含まれる微細 な形状変動が取り除かれて整形される。

【0208】 このようにフィルタ処理手段50によりロ ーパスフィルタ処理された基準の濃度ピーク点列(X i, Yi)は、CPU部17の指令によって基準形状登 録部52に予め登録される。

【0209】一方、画像信号記憶部19に記憶された被 検査画像データDIS中に存在する複数のレジスト穴バ ターン40から評価しようとするレジスト穴パターン4 0が選択され、その位置が特定される。

【0210】CPU部17は、上記図20に示す穴画像 をテンプレート画像又は基準画像Sとして図14又は図 15に示す被検査画像データDISとの正規化相互相関 演算を行い、類似度が指定値以上の位置を図21の 「+」に示すような穴パターン位置(Cx, Cy)とす る。

【0211】 このとき、複数のレジスト穴パターン40 の相対位置から画像の傾きがチェックされ、必要であれ ば傾き補正が行われる。

【0212】次に、CPU部17の検査領域設定手段3 0は、選択・位置特定された評価しようとするレジスト 穴パターン40の穴パターン位置(Cx, Cy)を中心 に、図16に示すテーバ検査領域Qの各楕円1、2を図 22に示すようにレジスト穴パターン40に対して設定 し、このテーパ検査領域Qにおいて、楕円1の内部でか つ楕円2の外側となる領域を検査領域として設定する。 【0213】次に、濃度ビーク点列手段31は、評価し ようとするレジスト穴パターン40に対して設定したテ ーパ検査領域Qにおいて、例えば図16に示すように穴 パターン40の中心(Cx, Cy)から各楕円1、2を 横切る各直線L1、L2、…、Lnを所定角度毎に設定 し、上記図23(a)~同図(c)に示すように各直線L1、 L2、…、Ln上の各輝度分布を取得する。

【0214】次に、濃度ピーク点列手段31は、各直線 L1、L2、…、Ln上の各輝度分布からそれぞれ各濃 度ピーク位置を求め、上記図17に示すような基準とす るレジスト穴パターン40のテーパ部の濃度ピーク点列 (Xi, Yi)を取得する。

【0215】次に、フィルタ処理手段50は、濃度ピー ク点列手段31により取得された評価しようとする濃度 ピーク点列(Xi, Yi)に対してローパスフィルタ処 理、すなわち濃度ピーク点列(Xi、Yi)をフーリエ 級数展開し、所定の次数までのフーリエ係数を用いて形 状復元する。

【0216】図30(a)(b)(c)はそれぞれ評価しようと する濃度ピーク点列(Xi, Yi)の原形状、高次スペー クトル(10次まで)による形状復元、低次スペクトル (2次まで)による形状復元を示す模式図である。これ ら図がら分かるように高次スペクトルによる形状復元 工係数を用いて形状復元することにより、SEM画像特 50 は、濃度ピーク点列(Xi, Yi)の原形状に近い形状

37

に復元されるが、低次スペクトルによる形状復元は、濃度ピーク点列(Xi, Yi)の原形状からずれて楕円に近い形状で復元されてしまう。

31

【0217】次に、評価手段51は、フィルタ処理手段50によってフーリエ級数展開した後に適当な次数までの係数を用いて図形を復元された評価しようとする濃度ピーク点列を受けるとともに、予め基準形状登録部52に登録されている基準の濃度ピーク点列を読み出し、これら評価しようとする濃度ピーク点列と基準の濃度ピーク点列と基準の濃度ピーク点列と基準の濃度ピーク点列となりそれぞれ形成される各パターンサイズの縦横比が同じになるように調整する。

【0218】なお、評価手段51は、基準形状登録部52に登録されている複数の基準の濃度ビーク点列の中から最適なフーリエ級数の係数の次数、例えば10次で復元した基準の濃度ビーク点列を読み出す。

【0219】次に、評価手段51は、評価しようとする 濃度ピーク点列と基準の濃度ピーク点列とをね合わせ、 これら濃度ピーク点列と基準とする濃度ピーク点列との 20 各パターン間のずれ量dの総和をレジスト穴パターン4 0の形状歪み評価値とする。

【0220】 このとき、上記の如くずれ量 d の評価関数 g では、微細なずれを無視するために、例えば $-\alpha < d$ $<+\alpha \rightarrow g$ (d) = 0 となるような不感帯を設定する パラメータ $\pm\alpha$ を設定したり、又大きなずれを強調評価 するために、g (d) = g * g 又は g (d) = exp(g) などの演算を実行している。

【0221】次に、評価手段51は、レジスト穴バターン40の形状歪み評価値と予め設定された良否判別基準 30値とを比較し、レジスト穴バターン40の良否判定を行う。

【0222】 このように上記第3の実施の形態において は、レジスト穴パターン40の形状に応じたテーパ検査 領域Q内の輝度分布に基づいて求められる濃度ピーク点 列に対してローパスフィルタ処理すなわちフーリエ級数 展開した後に適当な次数までの係数を用いて図形を復元 し、基準とする微小パターンの形状に応じた検査領域内 の輝度分布に基づいて求められる濃度ビーク点列に対し て同様にフーリエ級数展開した後に適当な次数までの係 40 数を用いて図形を復元し、これらローバスフィルタ処理 された評価しようとする濃度ピーク点列と基準とする濃 度ピーク点列とを比較してレジスト穴パターン40の評 価を行うようにしたので、レジスト穴パターン40の形 状の歪みを定量的に形状歪み評価値として検出すること ができ、かつこの形状歪み評価値を予め設定された良否 判別基準値と比較することでレジスト穴パターン40の 良否判定を行うことができる。

【0223】との場合、濃度ピーク点列に対してローバスフィルタ処理すなわちフーリエ級数展開した後に適当 50

な次数までの係数を用いて図形を復元するときのフーリエ級数の係数の次数は、被検査画像データDISのS/Nなどによって実験的に決定されるので、濃度ピーク点列手段31により取得された各濃度ピーク点列(Xi,Yi)により得られるパターン形状には、SEM画像特有のノイズ、輝度変化による影響のためにそのパターン形状に微細な形状変動が含まれているが、このような微細な形状変動を取り除き整形し、パターン形状歪みを評価するうえに阻害となる要因をなくして高精度に評価できる。

【0224】従って、LSI、超LSIなどの半導体プロセスの検査に適用すれば、これらLSIや超LSIなどの半導体素子の評価及び検査を容易かつ高精度に行うことができる。

【0225】なお、上記第3の実施の形態は、次の通り変形してもよい。

【0226】例えば、測定試料9としてはレジスト穴パターン40のように楕円に近い形状のものとしているが、これに限らずパターン形状の輪郭が閉曲線ならば準凸体であつてもよい。又、パターン形状の輪郭が閉曲線でなければ、凸体の一部であるならば検査に適用できる。

【0227】又、測定試料9としてLSIバターンを例にとって説明したが、これに限らずµmオーダの測定であれば如何なる測定試料に対しても微小バターンの形状検査に適用できる。

【0228】(4) 次に、本発明の第4の実施の形態について図面を参照して説明する。なお、図1と同一部分には同一符号を付してその詳しい説明は省略する。

【0229】図31は微小バターン形状検査装置の構成 図である。

【0230】上記CPU部17は、指定されたアドレスの画像信号DISを画像信号記録部19から読み出し、この画像信号DISに対して各種画像処理を行う演算機能と記憶機能とを有するもので、特に平滑化手段60、差分波形手段61、第1の幅計測手段62及び第2の幅計測手段63の各機能を有している。

【0231】とのうち平滑化手段60は、SEM本体部 1によってLSI等に形成された微小パターンを撮影し て得られた画像信号ISに対して複数の平滑化サイズで 波形の平滑化を行う機能を有している。

【0232】差分波形手段61は、平滑化手段60により得られる平滑化サイズの異なる各平滑化波形データの差分波形データを求める機能を有している。

【0233】第1の幅計測手段62は、差分波形手段6 1により求められた差分波形データとこの差分波形データを求めるのに差分波形手段61で用いた各平滑化波形データとに基づいて微小パターンの輪郭部分に対応する両側の各縁部を求め、これら縁部の間隔を微小パターンの線幅として求める機能を有している。

【0234】第2の幅計測手段63は、電子線束5の径 による畳み込みによるボケ量以上の平滑化サイズで求め た微小バターンの線幅の系列からその回帰曲線を求め、 この回帰曲線の平滑化サイズがゼロの位置の値から電子 線束5の径がゼロのときの微小パターンの線幅を求める 機能を有している。

【0235】次に上記の如く構成された装置の作用につ いて説明する。

【0236】SEM本体部1の電子光学鏡筒3の下部に は、例えばLSIなどの微小パターンが形成された半導 10 体ウエハ等の測定試料9が設置される。

【0237】電子銃4から電子線束5から放出される と、この電子線束5は、上記第1の実施の形態と同様 に、コンデンサレンズ6で縮小され、走査コイル7によ りX-Y方向にラスタ走査され、さらに対物レンズ8で 縮小されて測定試料9面に照射される。

【0238】 この測定試料9面から放出される二次電子 は、二次電子検出器10により検出されてその検出信号 が増幅部14を通って画像信号ISとして画像信号増幅 器15に送られ、との画像信号増幅器15により微小パ 20 ターンがCRT表示装置16で拡大表示される。

【0239】これと共に、画像信号ISは、A/D変換 部18によりA/D変換され、ラスタ走査及び走査線分 割により例えば512×512画素に分割されて、それ ぞれのアドレスにおけるディジタル画像信号をIS (i, j:但しi, j=0, 1, 3, …512) とアド レス化する。画像信号記憶部19は、これらディジタル 画像信号(SEM画像)DISをアドレスごとに記憶す る。

【0240】次に、CPU部17は、画像信号記憶部1 30 /2のとき、 9に記憶されたディジタル画像信号(被検査画像デー *

* タ) DISに対して演算機能を用いて微小パターンの寸 法測定を行う。

【0241】先ず、CPU部17は、画像信号記憶部1 9に記憶されている被検査画像データDISを読み出

【0242】次に、平滑化手段60は、CPU部17に より読み出された図32に示すような被検査画像データ DISに基づき、SEM本体部1によってLSI等に形 成された微小パターンを撮影して得られた1ラインの画 像信号ISに対して複数の平滑化サイズで波形の平滑化 を行う。

【0243】具体的に1ラインの画像信号を波形x(i) (ここでi=0, …, 511)とする。平滑化手段60 は、1ラインの画像信号を波形x(i) に対して複数の平 滑化サイズで波形の平滑化を行い、これら平滑化サイズ に対応した例えば10種類の平滑化波形p1(i)~p10 (i) を得る。

[0244]

平滑化サイズn=3 平滑化波形 p 1(i) 平滑化波形 p 2(i) 平滑化サイズ n=7 平滑化波形 p 3(i) 平滑化サイズ n=11 平滑化サイズn=15 平滑化波形 p 4(i) 平滑化波形 p 5(i) 平滑化サイズn=19 平滑化波形 p 6(i) 平滑化サイズn=23 平滑化サイズn=27 平滑化波形 p 7(i) 平滑化波形 p 8(i) 平滑化サイズn=31 平滑化波形 p 9(i) 平滑化サイズn=35 平滑化波形 p 10(i) 平滑化サイズn=39 CCC, i = (n-1)/2, ..., 511-(n-1)

1+(1-1)/2 $P_{k}(i) = (\Sigma \times (i)) / n$ 1 - (n-1)/2

...(9)

 $i < (N-1)/2 \forall i > 511 - (n-1)/2 \sigma$ ※を得る。 とき P_{k} (i) = 0.

【0245】なお、図33(a)~(e)は10種類の平滑化 波形 p 1(i)~ p 10(i)のうち平滑化波形 p 1(i)~ p 5(i) を示している。

である。

【0246】次に、差分波形手段61は、平滑化手段6 0により得られる平滑化サイズの異なる2つの波形を選 びその差分、つまり

平滑化サイズ小の波形-平滑化サイズ大の波形 を求め、以下に示すような各差分波形データS13~S81%

$$S_{1k(i)} = p_1(i) - p_k(i)$$

[0247]

差分波形S13(i) p1(i) - p3(i)差分波形 S 24(i) p2(i) - p4(i)差分波形 S 35(i) p 3(i) - p 5(i)差分波形 S 46(i) p 4(i) - p 6(i)差分波形 S 57(i) p 5(i) - p 7(i)差分波形 S 68(i) p6(i) - p8(i)差分波形 S 79(i) p7(i) - p9(i)差分波形 S 81(i) p8(i) - p10(i)とこで、平滑化サイズk>1とすると、i=(k-1)

/2、…、511-(k-1)/2のとき、

...(1

 $i < (k-1)/2 \forall i > 511 - (k-1)/2 \sigma$ とき

 $S_{1k(1)} = 0$

50 である。

(19)

【0248】なお、図34(a)~同図(c)はとれら差分波 形データS13~S81のうち差分波形データS13、S24、 S35を示している。

【0249】又、図35は各平滑化波形p1(i)~p10 (i) と各差分波形データS13~S81との関係を示してい る。

【0250】次に、第1の幅計測手段62は、差分波形 手段61により求められた差分波形データS13~S81 と、これら差分波形データS13~S81を求めるのに差分 波形手段61で用いた各平滑化波形データp1(i)~p10×10 -ク値Lmax から図中左方向へ

(Lmax-Lmin) /2

の値をとる位置Phを検索する。

α = 半値幅×2

として、

 $A = P \max - \alpha$

を求め、 $\beta = \alpha \times 25\%$ として、

 $B = P \max - \beta$

を求める。

【0254】 このようにして求められた差分波形データ S. (i)のA、B間の最小値をとる位置Cを求める。そ して、AC間を曲線近似して左ピーク位置 P.eak Lを求 める。この左ピーク位置PeakLは、サイズ小の平滑化 波形データ p 1(i)の微小パターン、下地境界位置(微小 バターンの左側の縁部) に対応している。

 $W_{1k} = | PeakL - PeakR |$

を求める。

【0257】一方、デフォーカスの状態の二次電子画像 から電子線束5のビーム径0時の微小パターンベース幅 の寸法の計測について説明する。

【0258】第2の幅計測手段63は、全ての差分波形 データS13~S81について上記同様に、それぞれの平滑 化サイズに対応した微小パターンベース幅の寸法、例え ばW13、W24、W35、W46、W57、W68、W79、W81を 計測する。

【0259】図37に示すようにシャストフォーカス時 の波形に対して微小パターンベース幅♥」を求めた場 合、この微小パターンベース幅W1,は、平滑化サイズが 大きくなるに従って大きくなっていく。

【0260】但し、この場合、物理的に電子線束5のビ ーム径はゼロとはできないため、微小パターンのビーム 40 径による畳み込みにより、平滑化サイズがゼロであって もビーム径分のボケが画像に発生し(物理的な解像度限 界)、図37上のジャストフォーカス時の原波形線幅 (ビーム径≠0)「△」に示すように原パターン幅より も大きい値をとることになる。同様な現象は、デフォー カス時により顕著に現れる。フォーカスずれが大きいほ どパターンに畳み込まれるビーム径が大きくなるため、 図37上のフォーカスずれ時の線幅(ビーム径大)

「□」に示すようなパターン線幅と波形平滑化サイズと の関係となる。

* (i)とに基づいて微小パターンの輪郭部分に対応する両 側の各縁部を求め、これら縁部の間隔を微小パターンの 線幅として求める。

【0251】具体的に図36に示すサイズ小の平滑化波 形データp1(i)、サイズ大の平滑化波形データp、(i) 及び差分波形データS,,(i)を用いて説明すると、サイ ズ大の平滑化波形データpk (i) の左側ピーク値Lmax (位置Pmax)と最小値Lmin (位置Pmin)を求める。 【0252】次に、平滑化波形データp。(i) の左側ビ

※ ※【0253】半値幅 | Pmax-Pmin | から

...(12)

... (13)

... (14)

★【0255】以上と同様にして右ピーク位置 PeakR (微小パターンの右側の縁部)を求める。

【0256】しかして、第1の幅計測手段62は、左ビ ーク位置Peak Lと右ピーク位置Peak Rとを用いて平 滑化波形データp, (i)の微小パターンベース幅の寸法 (線幅) ₩,,

...(15)

【0261】そとで、微小パターンベース幅₩1.の系列 からビーム径0時のパターン幅を求める。ビーム径によ る畳み込みによるボケ量以上の平滑化サイズで求めたバ ターン幅の系列、図37では微小パターンベース幅の寸 法₩68、₩79、₩81から回帰曲線を求め、この回帰曲線 の平滑化サイズがゼロの位置の値を計算することで図3 7に示すビーム径0時のパターン幅「○」を求めること ができる。回帰曲線の次数は実験により求めるもので、 この実施の形態では1次としている。

【0262】 これにより、ディフォーカス、ジャストフ ォーカス画像からビーム径 0 時の物理的な解像度限界以 上の精度でパターン幅を測定できる。

【0263】 このように上記第4の実施の形態において は、微小パターンを撮影して得られた画像信号における 微小バターンの輪郭部分に対応する両側の各縁部を求 め、これら縁部の間隔から微小パターンの線幅を求める ようにしたので、下地部分の不安定な濃度部分によらず 安定した微小バターンのテーバ部の濃度分布のみから微 小パターンの寸法測定を自動的に高精度に行うことがで きる。平滑化サイズが小さい差分波形例えば差分波形デ ータS13のみから微小パターンベース幅を求めるだけで も寸法計測の繰り返し再現性が向上する。

【0264】さらに、電子線束5の径による畳み込みに よるボケ量以上の平滑化サイズで求めた微小パターンの 50 線幅の系列からその回帰曲線を求め、この回帰曲線の平 滑化サイズがゼロの位置の値から電子線束5の径がゼロのときの微小パターンの線幅を求めるので、ディフォーカス、ジャストフォーカス画像からビーム径0時の物理的な解像度限界以上の精度でパターン幅を測定できる。

【0265】従って、LSI、超LSIなどの半導体プロセスに適用した場合、製品の評価及び検査を容易かつ高精度に行うことができる。

【0266】なお、上記第4の実施の形態は、次の通り変形してもよい。

【0267】例えば、波形データの平滑化を上記式(7) 10 を用いて行ったが、これに限らず電子線束5の電子密度形状に対応した平滑化を行ってもよい。例えば、電子線束5の電子密度形状が正規分布に従うならば、ガウシアンフィルタを用いるのが適切である。同様に平滑化を上記第4の実施の形態のように時間領域で行わず、フーリエ変換後に周波数領域で行い、逆フーリエ変換してもよい。

【0268】又、上記第4の実施の形態では、平滑化波形数、平滑化サイズ、差分波形数、差分間隔を特定の数としているがとれに限定されるものでない。平滑化波形 20数、差分波形数を多くすることでパターン幅の推定値をより高精度に求めることができる。平滑化サイズ、差分間隔についても上記第3の実施の形態では、等間隔であったが、間隔が既知であれば等間隔である必要はない。【0269】又、ビーム径0時のパターン幅推定にのみ注目すれば、各々の平滑化波形からパターン幅を求める部分については、他の方法を用いてもよい。例えば、差分波形を用いないで、平滑化波形のパターンテーパ部、下地部各々を直線近似して、その交点(左右の)からパターン幅を求めてもよい。

【0270】又、上記第4の実施の形態では、横方向のバターン幅の寸法計測について説明したが、縦、斜めなどの方向のバターン幅計測に対しても、電子線束5の走査方向を変えることで対応できる。電子線束5の走査方向を変えずに、1ライン波形データの取得方向を変えることでも対応できる。

【0271】又、上記第4の実施の形態では、バターンベース幅を求めたが、これに限らず得られた波形データに下地部(平面部)とテーバ部とがあれば、バターンビッチ、バターントップ幅などを求めることができる。 【0272】さらに、波形データとして1ラインのデータを用いたが、複数ラインの任意の積算データを対象としてもよい。

【0273】又、測定試料9としてLSIパターンを例 にとって説明したが、これに限らずμmオーダの測定であれば如何なる測定試料に対しても微小パターンの形状 検査に適用できる。

[0274]

【発明の効果】以上詳記したように本発明によれば、精 【図18】同装置における即度高く微小バターンの検査ができる微小バターン形状検 50 データ取得の作用を示す図。

査方法及びその装置を提供できる。

【0275】又、本発明によれば、微小バターンの形状 検査を自動的に高精度に行うことができる微小バターン 形状検査方法及びその装置を提供できる。

【0276】又、本発明によれば、多様な形状で変形や 歪みのある微小パターンのテーパ部の形状検査を自動的 に高精度に行うことができる微小パターン形状検査方法 及びその装置を提供できる。

[0277] 又、本発明によれば、微小パターンの形状 歪みを自動的に高精度に行うことができる微小パターン 形状検査方法及びその装置を提供できる。

【0278】又、本発明によれば、微小パターンの寸法 測定を自動的に高精度に行うことができる微小パターン 形状検査方法及びその装置を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係わる微小パターン形状検査装置の第 1の実施の形態を示す全体構成図。

【図2】同装置における検査機能メインフローチャート。

【図3】同装置における基準画像生成フローチャート。

【図4】同装置における基準画像生成手段により作成される基準画像データのうち上限濃淡画像データ及び下限 濃淡画像データを示す模式図。

【図5】同装置における差画像取得フローチャート。

【図6】同装置における欠陥抽出フローチャート。

【図7】同装置における基準画像生成手段で使用するマトリックスの模式図。

【図8】同装置で生成される基準平均微分2値化画像データ及び被検査微分2値化画像データの模式図。

30 【図9】同装置における精密位置合わせフローチャート。

【図10】同装置で用いられる被検査画像データ及び上 限濃淡画像データの模式図。

【図11】同装置により求められる濃淡差画像データの作用を示す模式図。

【図12】同装置における差画像取得の別の例のフローチャート。

【図13】本発明に係わる微小パターン形状検査装置の 第2の実施の形態を示す全体構成図。

40 【図14】同装置のSEM本体部で得られる半導体の穴 パターンの画像を示す図。

【図15】同装置のSEM本体部で得られる半導体の穴パターンの画像を示す図。

【図16】同装置により半導体の穴パターンの画像に設定するテーパ検査領域を示す模式図。

【図17】同装置によりテーバ検査領域を横切る各直線 上の各輝度分布から得られる濃度ピーク点列を示す模式 図。

【図18】同装置における取得濃度データ手段での濃度 データ取得の作用を示す図 【図19】同装置における取得濃度データ手段での濃度 データ取得範囲を示す模式図。

【図20】同装置におけるレジスト穴パターン40を選択・位置特定のための基準画像を示す模式図。

【図21】同装置により基準画像で特定された穴パターン位置を示す模式図。

【図22】同装置におけるテーパ検査領域の各楕円をレジスト穴パターンに対して設定した模式図。

【図23】同装置でレジスト穴パターンに設定したテー パ検査領域を横切る各直線上の各輝度分布を示す模式 図。

【図24】同装置における濃度データ取得範囲における レジスト穴パターンのテーパ部分の輝度情報を示す模式 図。

【図25】同装置における欠陥判定手段の判定作用を示す図。

【図26】同装置における欠陥判定手段の判定作用を示す図。

【図27】本発明に係わる微小パターン形状検査装置の 第3の実施の形態を示す全体構成図。

【図28】同装置におけるパターン形状のスペクトル処理について説明するための図。

【図29】同装置により求められる基準の濃度ピーク点列の原形状、高次スペクトルによる形状復元、低次スペクトルによる形状復元、低次スペクトルによる形状復元を示す模式図。

【図30】同装置により求められる評価しようとする濃度ピーク点列の原形状、高次スペクトルによる形状復元、低次スペクトルによる形状復元を示す模式図。

【図31】本発明に係わる微小バターン形状検査装置の 第4の実施の形態を示す全体構成図。

【図32】同装置のSEM本体部1により撮影された1 ラインの画像信号を示す図。

【図33】同装置の平滑化手段により得られる平滑化波 形の模式図。

【図34】同装置の差分波形手段により得られる差分波 形の模式図。

【図35】同装置により得られる各平滑化波形と各差分 波形データとの関係を示す図。 *【図36】同装置による微小バターンの線幅の計測作用を説明するための模式図。

【図37】同装置によるデフォーカスの状態の二次電子 画像から電子線束のビーム径0時の微小パターンベース 幅の寸法計測の作用を説明するための模式図。

【符号の説明】

1:SEM本体部、

2:パターン検査部、

3:電子光学鏡筒、

10 4:電子銃、

6:コンデンサレンズ、

7:走査コイル、

8:対物レンズ、

9: 測定試料、

10:二次電子検出器、

11:基準信号発生部、

12: 掃引信号発生部、

15:画像信号增幅器、

16:CRT表示装置、

20 17:CPU部、

18:A/D変換部、

19: 画像信号記憶部、

20:D/A変換部、

21:基準画像生成手段、

22:差画像抽出手段、

23:欠陥抽出手段、

30:検査領域設定手段、

31:濃度ピーク点列手段、

32:取得濃度データ手段、

30 33: 欠陥判定手段、

40:レジスト穴パターン、

50:フィルタ処理手段。

51:評価手段、

52:基準形状登録部、

60:平滑化手段、

61:差分波形手段、

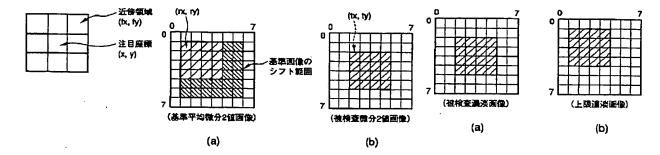
62:第1の幅計測手段、

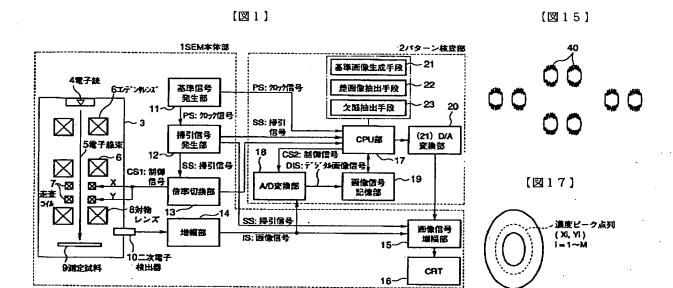
63:第2の幅計測手段。

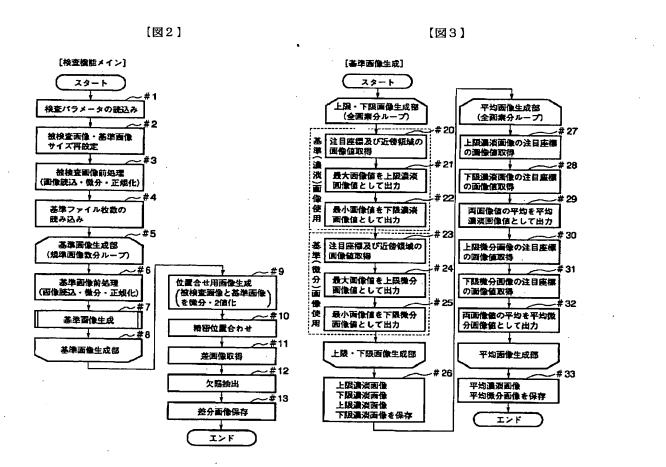
[図7]

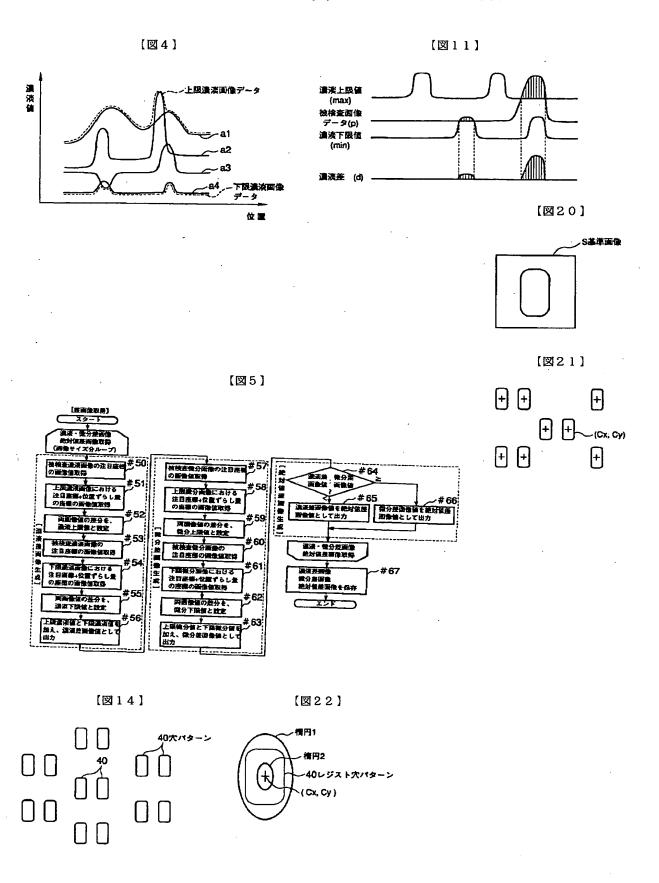
【図8】

【図10】



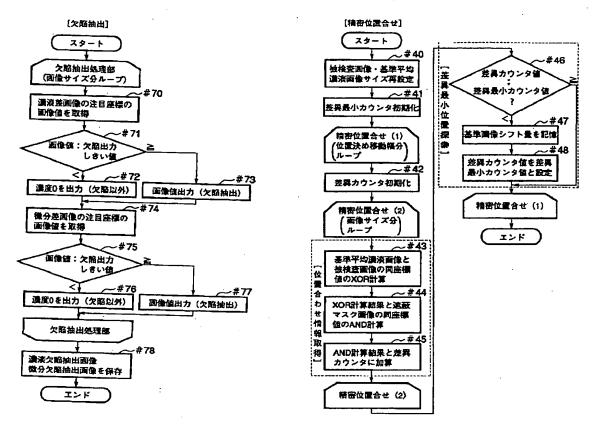




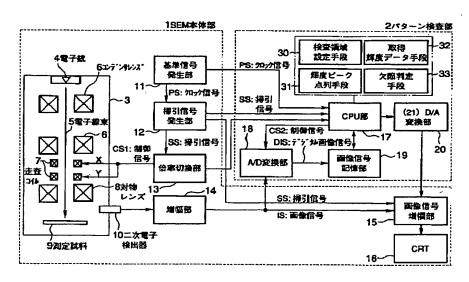


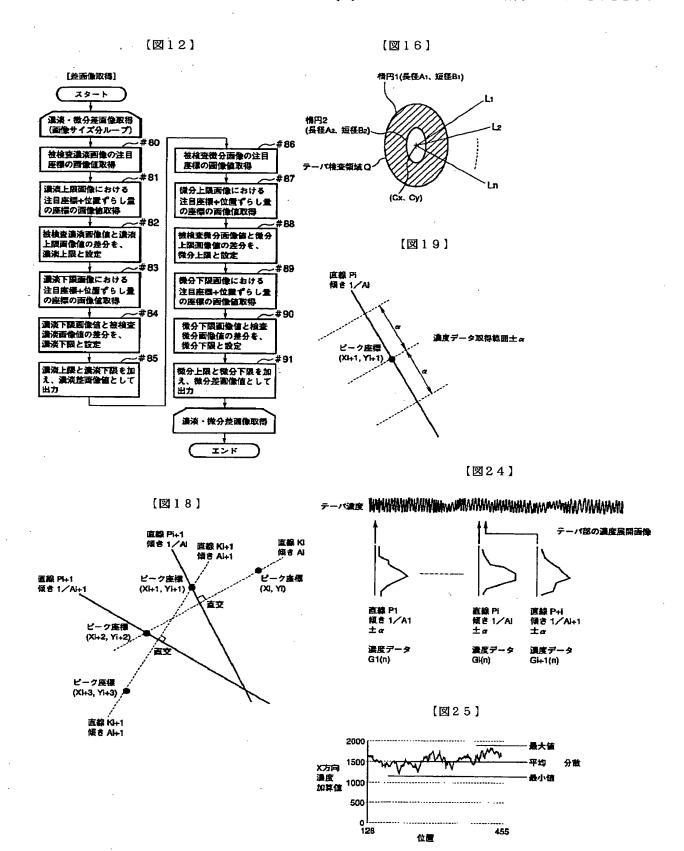
【図6】

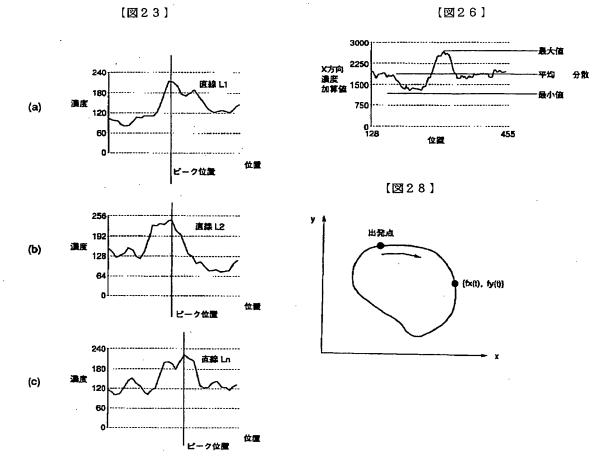
[図9]



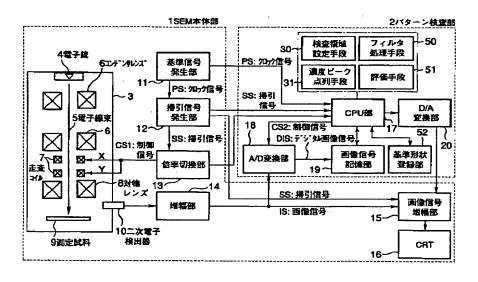
【図13】

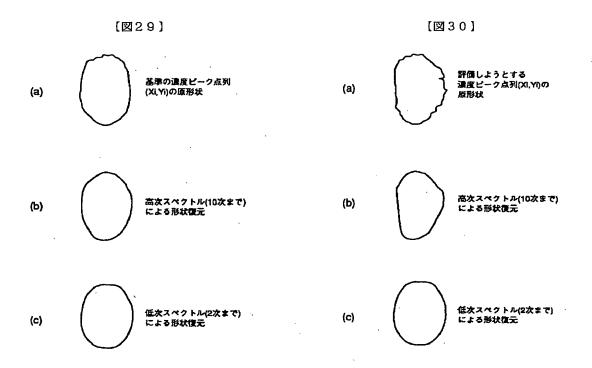




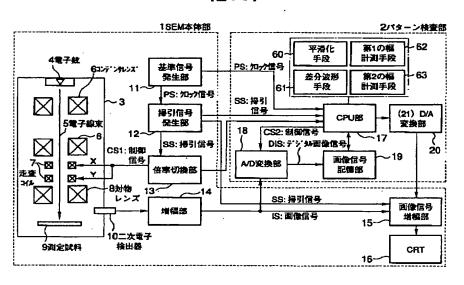


[図27]

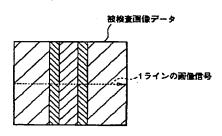




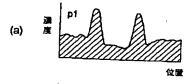
【図31】



[図32]

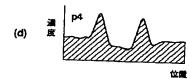


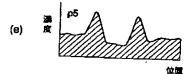
【図33】











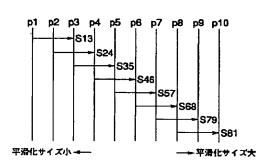
【図34】



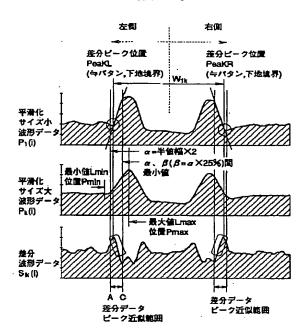




【図35】



[図36]



【図37】

